

AC/DC Drivers

Quasi-Resonant Control DC/DC converter IC

BM1Q104FJ

●概要

擬共振コントローラタイプ DC/DC コンバータ IC
BM1Q104FJ はコンセントが存在する製品に最適なシステム
を供給します。擬共振動作のためソフトスイッチングを実現
し、低 EMI に貢献します。

スイッチング MOSFET 及び電流検出抵抗が外付けのため、自由度の高い電源設計が可能です。

本 IC は起動回路を内蔵しており、低待機電力および高速起動に貢献します。

軽負荷時にはバースト機能を内蔵、およびIC消費電流が低い
ため待機電力が小さくなります。

またトランスの音鳴きを防ぐために、通常負荷時にボトム数を一定とする制御を実施しており、バースト時にはモスキート音(6kHz~20kHz)抑制機能を内蔵しています。

本 IC は、ソフトスタート機能、バースト機能、サイクルごとの過電流リミッタ、過電圧保護、過負荷保護、CS オープン時保護など種々の保護機能を内蔵しており、安全性に優れています。

●重要特性

- 動作電源電圧範囲: VCC : 14.0V to 30.0V
VH : to 600V
- 動作電流: 通常時 : 0.60mA (Typ)
バースト時 : 0.37mA(Typ)
- 動作温度範囲: -40°C to +85°C

●特長

- 擬似共振方式
- 650V 耐圧起動回路
- 無負荷時 低消費電力(軽負荷時バースト動作)
- ボトムスキップ機能
- 音鳴り防止制御
- モスキート音抑制機能
- VCC 端子 低電圧保護
- サイクルごとの過電流保護回路
- 出力ドライバ 12.5V クランプ回路
- ソフトスタート
- ZTトリガマスク機能
- ZT 端子 DC 過電圧保護
- 出力過負荷保護 [自己復帰]
- CS 端子 オープン保護回路 [自己復帰]

●パッケージ

SOP-J8 6.00mm×4.90mm ×1.65mm ピッチ 1.27mm
(Typ) (Typ) (Max) (Typ)



●アプリケーション回路

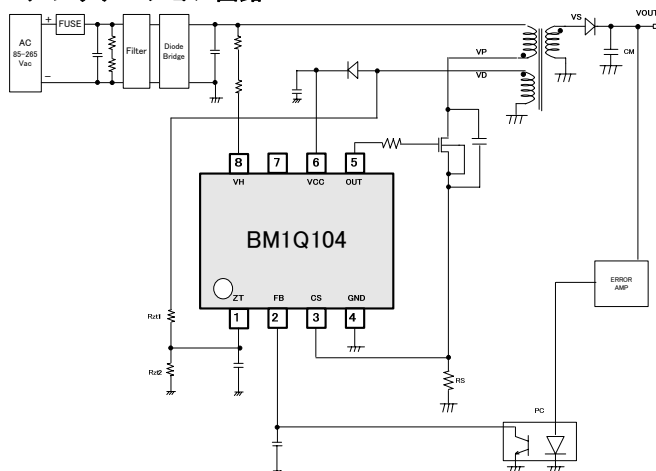


Figure 1. アプリケーション回路

●アプリケーション

プリンタ, コピー機, AC アダプタ, etc

●絶対最大定格 (Ta=25°C)

項 目	記号	定 格	単位	条 件
電圧範囲 1	Vmax1	-0.3 ~ 30	V	VCC
電圧範囲 2	Vmax2	-0.3 ~ 6.5	V	CS, FB
電圧範囲 3	Vmax3	-0.3 ~ 15	V	OUT
電圧範囲 4	Vmax4	-0.3 ~ 650	V	VH
OUT 端子出力ピーク電流	I _{OUT}	±0.50	A	
ZT 端子電流	I _{SZT}	±3.00	mA	
許容損失	Pd	0.68 (Note1)	W	
動作温度範囲	Topr	-40 ~ +85	°C	
最大ジャンクション温度	Tjmax	150	°C	
保存温度範囲	Tstr	-55 ~ +150	°C	

(Note 1) 70×70×1.6mm(ガラスエポキシ 1 層基板)に実装時。Ta=25°C以上で使用する時は 5.4mW/°Cで減じる。

●推奨動作条件 (Ta=25°C)

項 目	記号	定 格	単位	条 件
電源電圧範囲 1	V _{CC}	14.0~30.0	V	VCC
電源電圧範囲 2	V _H	80~600	V	VH
動作電圧範囲 3	V _{ZT}	~7.0	V	ZT
トランス共振時間	T _{RT}	0.5 ~ 4.0	us	

●電気的特性 (特に指定のない限り Ta=25°C、VCC=15V)

項目	記号	仕様			単位	条件
		最小	標準	最大		
【回路電流】						
回路電流(OFF)	I _{OFF}	-	16	50	uA	VCC=12V (UVLO 動作時)
回路電流(ON)1	I _{ON1}	-	600	1000	uA	FB=2.0V (PULSE 動作時)
回路電流(ON)2	I _{ON2}	-	370	500	uA	FB=0.3V (PULSE 動作 OFF 時)
回路電流(LATCH)	I _{LATCH}	-	250	400	uA	FB:OPEN (ラッチ停止時)
【VH 端子 起動回路】						
VH 起動電流 1	I _{START1}	0.40	0.70	1.00	mA	VCC= 0V
VH 起動電流 2	I _{START2}	1.00	3.00	6.00	mA	VCC=10V
VH OFF 電流	I _{START3}	-	10	20	uA	VCCUVLO 解除後 VH 端子流入電流
VH 起動電流切り替え電圧	V _{SC}	0.400	0.800	1.400	V	VCC 端子
【VCC 端子 保護機能】						
VCC UVLO 電圧 1	V _{UVLO1}	12.50	13.50	14.50	V	VCC 上昇時
VCC UVLO 電圧 2	V _{UVLO2}	7.20	8.20	9.20	V	VCC 下降時
VCC UVLO ヒステリシス	V _{UVLO3}	-	5.30	-	V	V _{UVLO3} = V _{UVLO1} -V _{UVLO2}
VCC 低下時充電開始電圧	V _{CHG1}	7.70	8.70	9.70	V	起動回路動作電圧
VCC 充電終了電圧	V _{CHG2}	12.00	13.00	14.00	V	V _{CHG1} からの停止電圧
ラッチ解除電圧	V _{LATCH}	-	V _{UVLO2} - 0.50	-	V	
ラッチマスク時間	T _{LATCH}	50	100	200	us	
【OUT 端子 】						
OUT 端子 H 電圧	V _{OUTH}	10.5	12.5	14.5	V	IO=-20mA VCC=15V
OUT 端子 L 電圧	V _{OUTL}	-	-	0.30	V	IO=+20mA
OUT 端子 プルダウン抵抗	R _{PDOUT}	75	100	125	kΩ	

●電気的特性 (特に指定のない限り Ta=25°C、VCC=15V)

項目	記号	仕様			単位	条件
		最小	標準	最大		
【DC/DC コンバータ部 (ターンオフ)】						
FB 端子プルアップ抵抗 1	R _{FB1}	22.5	30.0	37.5	kΩ	
FB 端子プルアップ抵抗 2	R _{FB2}	R _{FB1} × 0.783	R _{FB1} × 0.833	R _{FB1} × 0.883	kΩ	バースト時
CS 過電流検出電圧 1A	V _{lim1A}	0.475	0.500	0.525	V	FB=3.2V
CS 過電流検出電圧 2A	V _{lim2A}	0.015	0.050	0.085	V	FB=0.3V
電圧ゲイン 1 (ΔVFB/ΔVCS)	AV _{CS1}	5.40	6.00	6.60	V/V	
FB バースト電圧	V _{BURST}	0.25	0.30	0.35	V	
最大バースト周波数	F _{OSCB}	3.2	4.0	4.8	kHz	
FB プルアップ抵抗変更電圧	V _{BSTCH}	V _{BURST} × 1.20	V _{BURST} × 1.33	V _{BURST} × 1.42	V	
CS Leading Edge Blank 時間	T _{LEB}	-	0.25	-	us	
ターンオフ時間	T _{OFF}	-	0.25	-	us	CS 端子に PULSE 印加時
最小 ON 幅	T _{min}	-	0.50	-	us	T _{LEB} + T _{OFF}
最大 ON 幅	T _{max}	30.0	39.0	50.7	us	
【DC/DC コンバータ部 (ターンオン)】						
ボトム数切り替え ONOFF 幅 12	T1 _{BTM12}	8.10	9.00	9.90	us	ボトム数 1→2
ボトム数切り替え ONOFF 幅 23	T1 _{BTM23}	7.20	8.00	8.80	us	ボトム数 2→3
ボトム数切り替え ONOFF 幅 34	T1 _{BTM34}	6.13	7.00	7.88	us	ボトム数 3→4
ボトム数切り替え ONOFF 幅 45	T1 _{BTM45}	5.25	6.00	6.75	us	ボトム数 4→5
ボトム数切り替え ONOFF 幅 21	T1 _{BTM21}	12.60	14.00	15.40	us	ボトム数 2→1
ボトム数切り替え ONOFF 幅 32	T1 _{BTM32}	10.53	11.70	12.87	us	ボトム数 3→2
ボトム数切り替え ONOFF 幅 43	T1 _{BTM43}	9.00	10.00	11.00	us	ボトム数 4→3
ボトム数切り替え ONOFF 幅 54	T1 _{BTM54}	7.74	8.60	9.46	us	ボトム数 5→4
ZT コンパレータ電圧 1	V _{ZT1}	60	100	140	mV	ZT 下降時
ZT コンパレータ電圧 2	V _{ZT2}	120	200	280	mV	ZT 上昇時
ZT コンパレータヒステリシス	V _{ZTHYS}	-	100	-	mV	
ZT トリガマスク時間	T _{ZTMASK}	1.0	2.0	3.0	us	OUT H→L,ノイズ防止用
ZT トリガ タイムアウト時間	T _{ZTOUT}	10.5	15.0	19.5	us	最終 ZT トリガからカウント
【DC/DC 保護機能】						
ソフトスタート時間	T _{SS}	2.80	4.00	5.20	ms	
CS 端子プルアップ抵抗	R _{cs}	0.70	1.00	1.30	MΩ	
FB OLP 電圧 a	V _{FOLP1A}	3.20	3.40	3.60	V	過負荷検出 (FB 上昇時)
FB OLP 電圧 b	V _{FOLP1B}	-	V _{FOLP1A} × 0.94	-	V	過負荷検出 (FB 下降時)
FB OLP 検出タイマー	T _{FOLP}	44.8	64.0	83.2	ms	
FB OLP 停止タイマー	T _{OLPST}	358	512	666	ms	
ZT OVP 電圧	V _{ZTI}	3.325	3.500	3.675	V	

*3 RFB1 と RFB2 は連動するため、必ず RFB1 は RFB2 より大きくなります。

*4 VBURST と VBSTCH は連動するため、必ず VBURST は VBSTCH より小さくなります。

●ピン配置

Table1 入出力 PIN 機能

NO.	Pin Name	I/O	Function	ESD 保護系統	
				VCC	GND
1	ZT	I	ゼロ電流検出端子	-	○
2	FB	I	フィードバック信号入力端子	○	○
3	CS	I	一次側電流センス端子	○	○
4	GND	I/O	GND 端子	○	-
5	OUT	O	外付け MOS ドライブ端子	○	○
6	VCC	I/O	電源端子	-	○
7	N.C.	-	Non Connection	-	-
8	VH	I	起動回路端子	-	○

●外形図

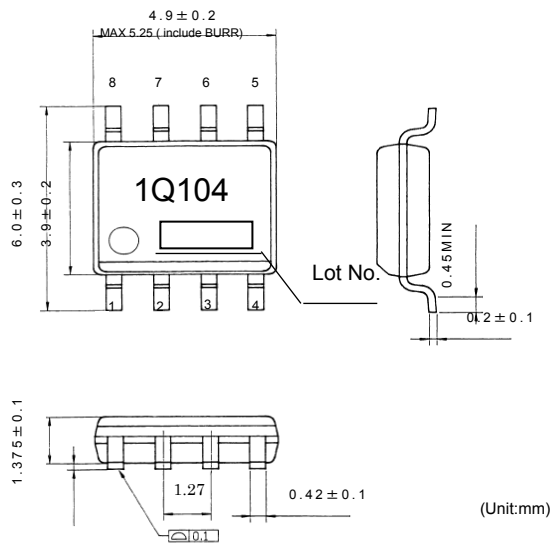


Figure 2. SOP-J8 パッケージ外形図

●入出力等価回路図

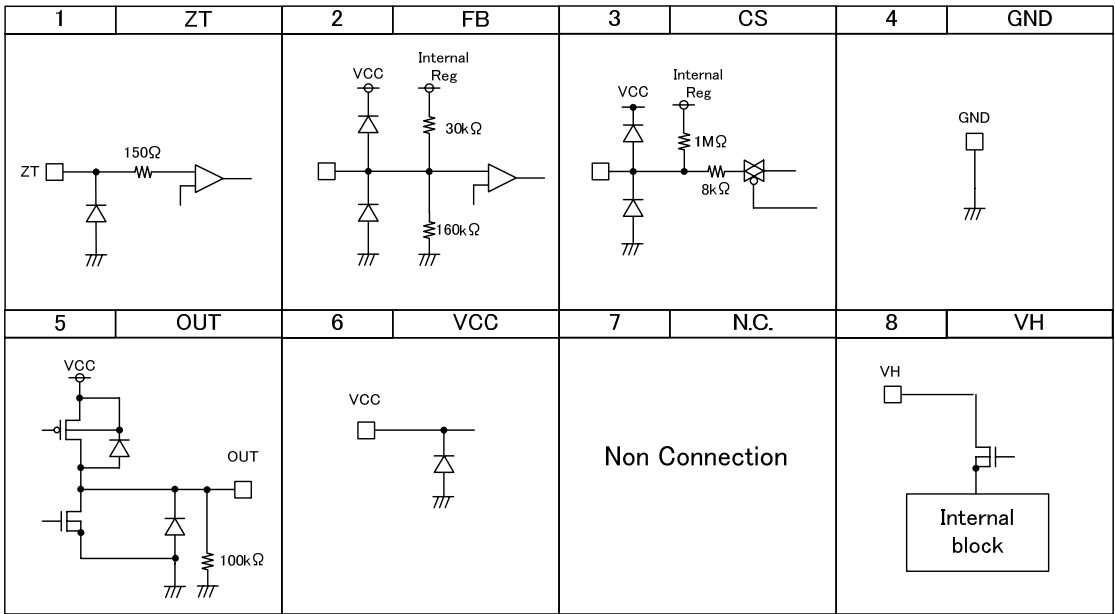


Figure 3. 入出力等価回路図

●ブロックダイアグラム

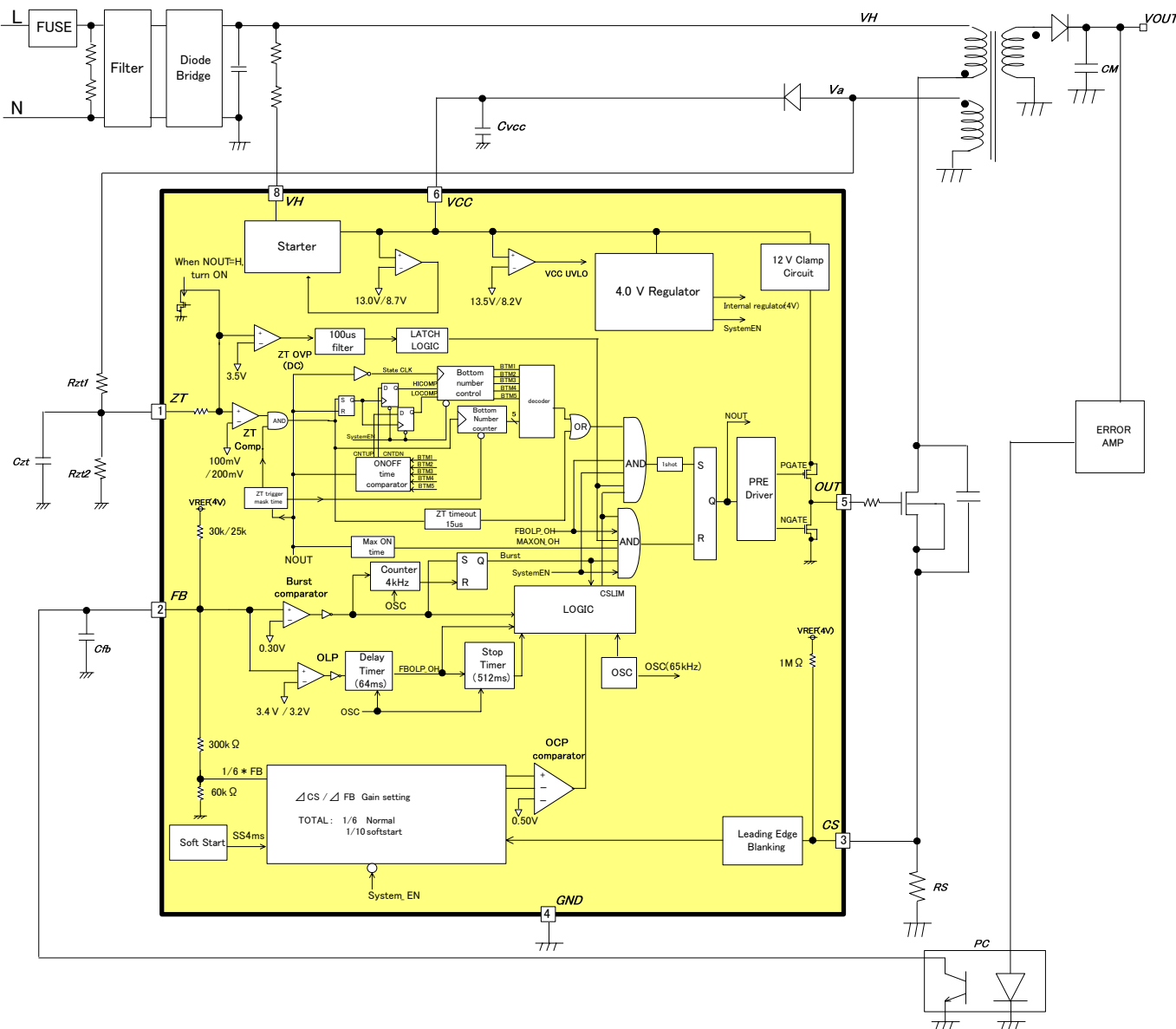


Figure 4. ブロック図

●各ブロックの説明

1. 起動回路 VH 端子(8pin)

本 IC は、VH 端子(8pin)に起動回路(650V 耐圧)を内蔵しています。そのため、低待機電力かつ高速起動が可能となります。
IC 起動後は、VH 端子(8pin)からアイドル電流 I_{START3} (typ=10uA) が流れます。
動時間は VCC 端子(6pin)のコンデンサ容量によって変化します。起動時間の参考値を Figure 7.に示します。

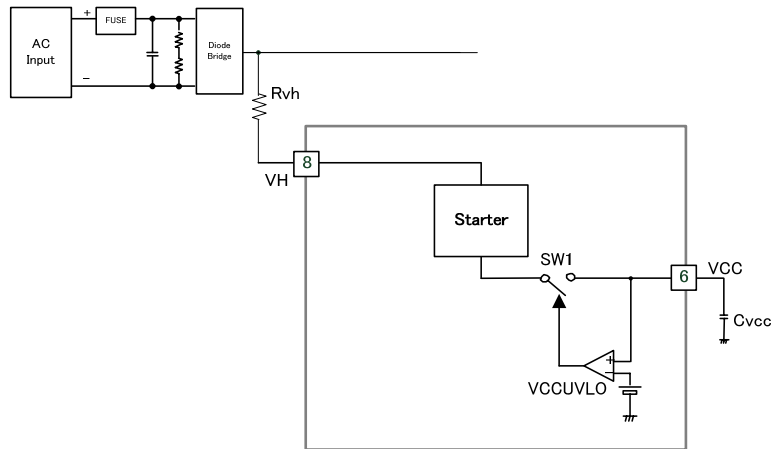


Figure 5. 起動回路ブロック図

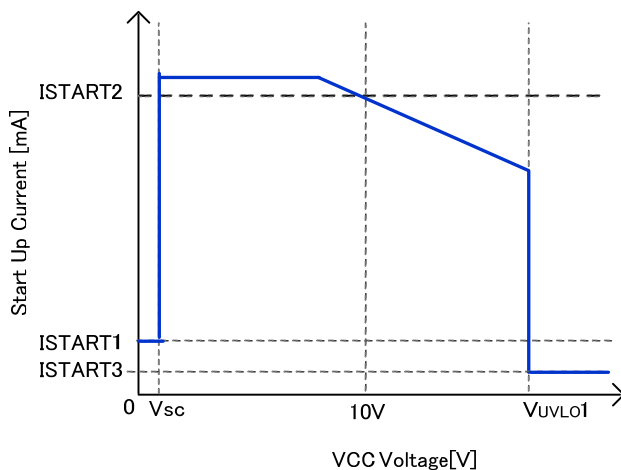


Figure 6. 起動電流 vs VCC 電圧

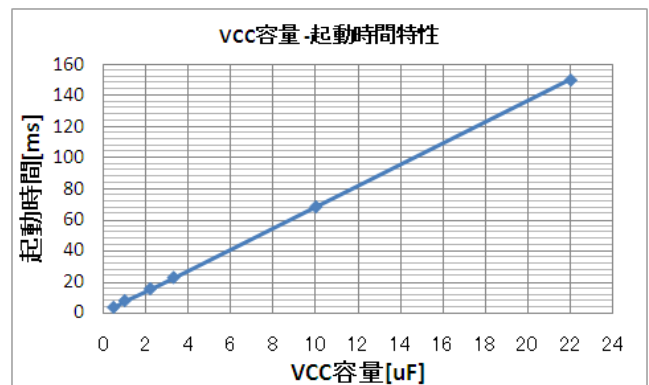


Figure 7. 起動時間(参考値)

*起動電流は、VH 端子(8Pin) からの電流です。

ex) 起動回路単体の消費電力

$$V_{ac}=100V \quad Power=100V \cdot \sqrt{2} \cdot 10\mu A=1.41mW$$

$$V_{ac}=240V \quad Power=240V \cdot \sqrt{2} \cdot 10\mu A=3.38mW$$

2. 起動シーケンス（起動ソフトスタート動作、軽負荷動作、過負荷保護による自己復帰動作）

本 IC の起動シーケンスを Figure 8. に示します。

各々の詳細な説明は、各章で説明します。

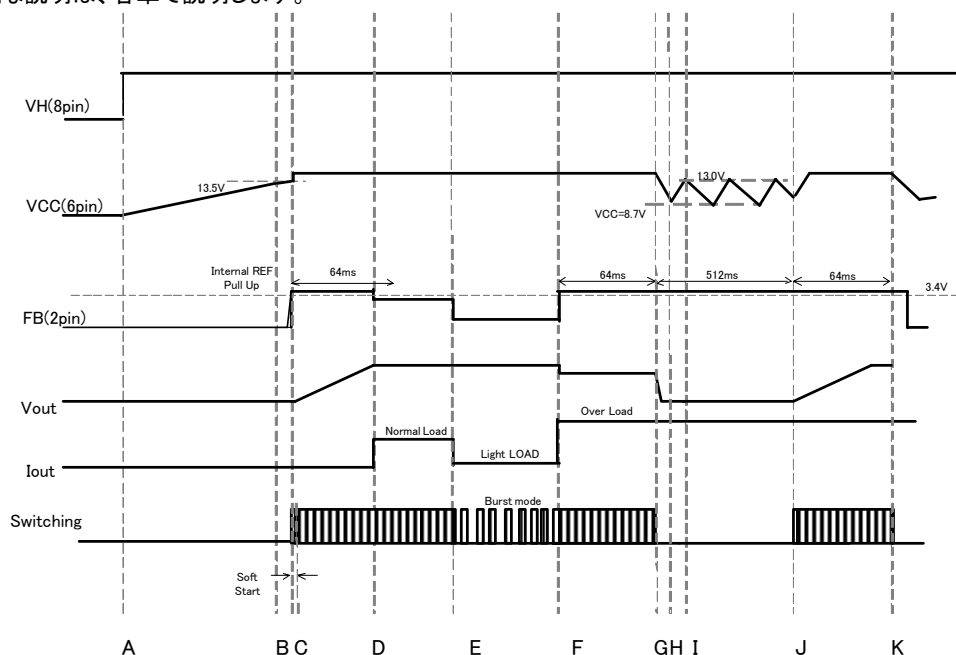


Figure 8. 起動シーケンス タイムチャート

- A: 入力電圧 VH 端子(8Pin)に電圧印加
- B: VCC 端子(6pin)電圧が上昇し、 $VCC > V_{UVLO1}$ (typ = 13.5V) を超えると本 IC が動作開始。
保護機能=正常と判断した場合、スイッチング動作を開始します。
そのとき VCC 端子(6pin)の消費電流により、必ず VCC 端子電圧が降下します。 $VCC < V_{CHG1}$ (typ = 8.7V) となった場合、起動回路が動作し、VCC を充電します。充電開始後は $VCC > V_{CHG1}$ (typ = 13.0V) となるまで充電を続けます。
- C: ソフトスタート機能を有しており、過度な電圧上昇、電流上昇が起こらないように、CS 端子(3pin)の電圧レベルを調整します。
- D: スイッチング動作が開始すると、2 次側出力電圧 VOUT が上昇します。
スイッチング開始後、出力電圧は T_{FOLP} (typ = 64ms) 以内に規定の電圧になるように設定してください。
- E: 軽負荷時には電力を抑えるため、バースト動作となります。
- F: 過負荷動作時には出力電圧が低下するため、FB 端子(2pin)電圧 $> V_{FOLP1A}$ となります。
- G: FB 端子(2pin)電圧 $> V_{FOLP1A}$ の状態が T_{FOLP} (typ = 64ms) 以上続いた場合、過負荷保護回路により T_{OLPST} (typ = 512ms) の間、スイッチング動作を停止します。
FB 端子(2pin)電圧 $< V_{FOLP1B}$ の状態になると、IC 内部タイマー T_{FOLP} (typ = 64ms) はリセットされます。
- H: VCC 電圧(6pin)が VCC 端子(6pin)電圧 $< V_{CHG1}$ (typ = 8.7V) 以下のとき、起動回路が動作して VCC 端子(6pin)を充電開始します。
- I: VCC 電圧が VCC 端子(6pin)電圧 $> V_{CHG2}$ (typ = 13.0V) 以上になると、起動回路による VCC 端子(6pin)への充電が停止します。
- J: F と同じです。
- K: G と同じです。

3. VCC 端子(6pin)保護機能

本 IC には VCC 端子(6pin)の低電圧保護機能 VCC UVLO (Under Voltage Protection)と VCC 電圧が低下した場合に動作する VCC 充電機能が内蔵されています。

VCCUVLO は VCC 電圧低下時にスイッチング用 MOSFET の破壊を防止するための機能です。

VCC 充電機能は VCC 電圧低下時に起動回路より高電圧ラインから充電を行い、二次側出力電圧を安定化します。

(1) VCC UVLO

VCC UVLO は電圧ヒステリシスを持つ自己復帰コンパレータです。Figure 9.にその動作を示します。

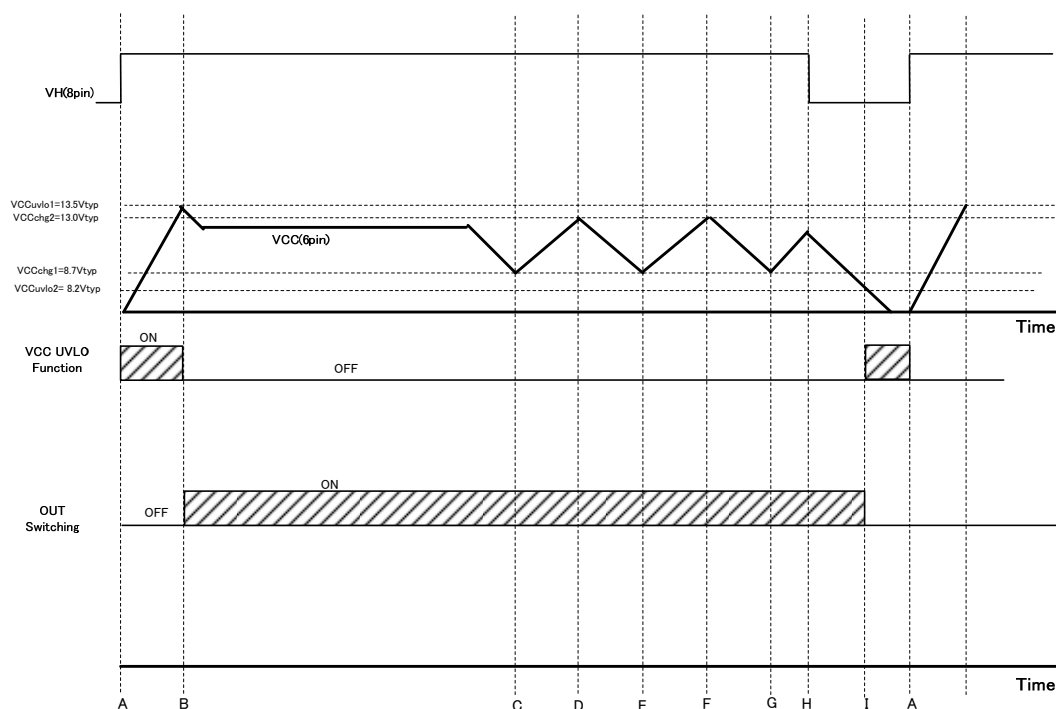


Figure 9. VCC UVLO タイムチャート

- A: VH 端子(8pin) 電圧印加、VCC 端子(6pin) 電圧が上昇開始
- B: VCC 端子(6pin) 電圧 > V_{UVLO1} 、VCC UVLO 機能が解除され、DC/DC 動作開始します。
- C: VCC 端子(6pin) 電圧 < V_{CHG1} 、VCC 充電機能が動作して VCC 端子(6pin) 電圧を上昇します。
- D: VCC 端子(6pin) 電圧 > V_{CHG2} 、VCC 充電機能が停止します。
- E: C と同じです。
- F: D と同じです。
- G: C と同じです。
- H: 高電圧ライン VH が低下。
- I: $VCC < V_{UVLO2}$ 、VCC UVLO 機能が動作します。

(2)VCC 充電機能

一度 VCC 端子(6pin) $>V_{UVLO1}$ となり IC が起動してから、VCC 端子電圧が VCC 端子(6pin) $<V_{CHG1}$ に低下すると、VCC 充電機能が動作します。VH 端子から起動回路を通して VCC 端子(6pin)を充電します。この動作により、VCC 起動不良を防ぎます。VCC 端子(6pin)を充電して、VCC 端子 $>V_{CHG2}$ に上昇すると、充電を終了します。この動作を Figure 10.に示します。

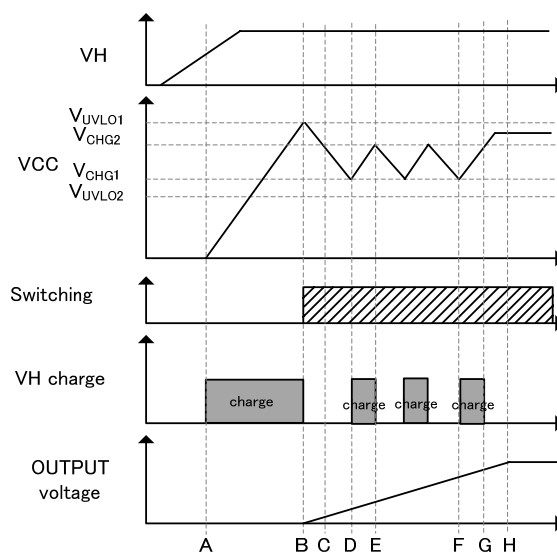


Figure 10. VCC 端子充電動作

- A: VH 端子(8pin)電圧が上昇して、VCC 充電機能により VCC 端子(6pin)に充電開始
 B: VCC 端子(6pin)電圧 $>V_{UVLO1}$ 、VCC UVLO 機能が解除され、VCC 充電機能が停止し、DC/DC 動作開始します。
 C: 起動時、出力電圧が低いため VCC 端子(6pin)電圧が低下します。
 D: VCC 端子(6pin)電圧 $<V_{CHG1}$ 、VCC 充電機能が動作して VCC 端子(6pin)電圧を上昇します。
 E: VCC 端子(6pin)電圧 $>V_{CHG2}$ 、VCC 充電機能が停止します。
 F: VCC 端子(6pin)電圧 $<V_{CHG1}$ 、VCC 充電機能が動作して VCC 端子(6pin)電圧を上昇します。
 G: VCC 端子(6pin)電圧 $>V_{CHG2}$ 、VCC 充電機能が停止します。
 H: 出力電圧が安定し、補助巻線より VCC 端子(6pin)に充電が安定すると、VCC 端子(6pin)が安定します。

注)VCC 端子電圧設定は、必ず V_{CHG2} (Max=14.0V) よりも大きくなるように、補助巻き線の電圧を設定してください。

4. DC/DC ドライバ

本 IC は、PFM(Pulse Frequency Modulation) モード制御方式です。FB 端子(2pin)と ZT 端子(1pin)及び CS 端子をモニタすることにより、DC/DC として最適なシステムを供給します。FB 端子(2pin)と CS 端子(3pin)でスイッチング MOSFET の ON 幅(ターンオフ)を制御し、ZT 端子(1pin)で OFF 幅(ターンオン)を制御します。以下に詳細な説明を示します。(Figure 11.参照)

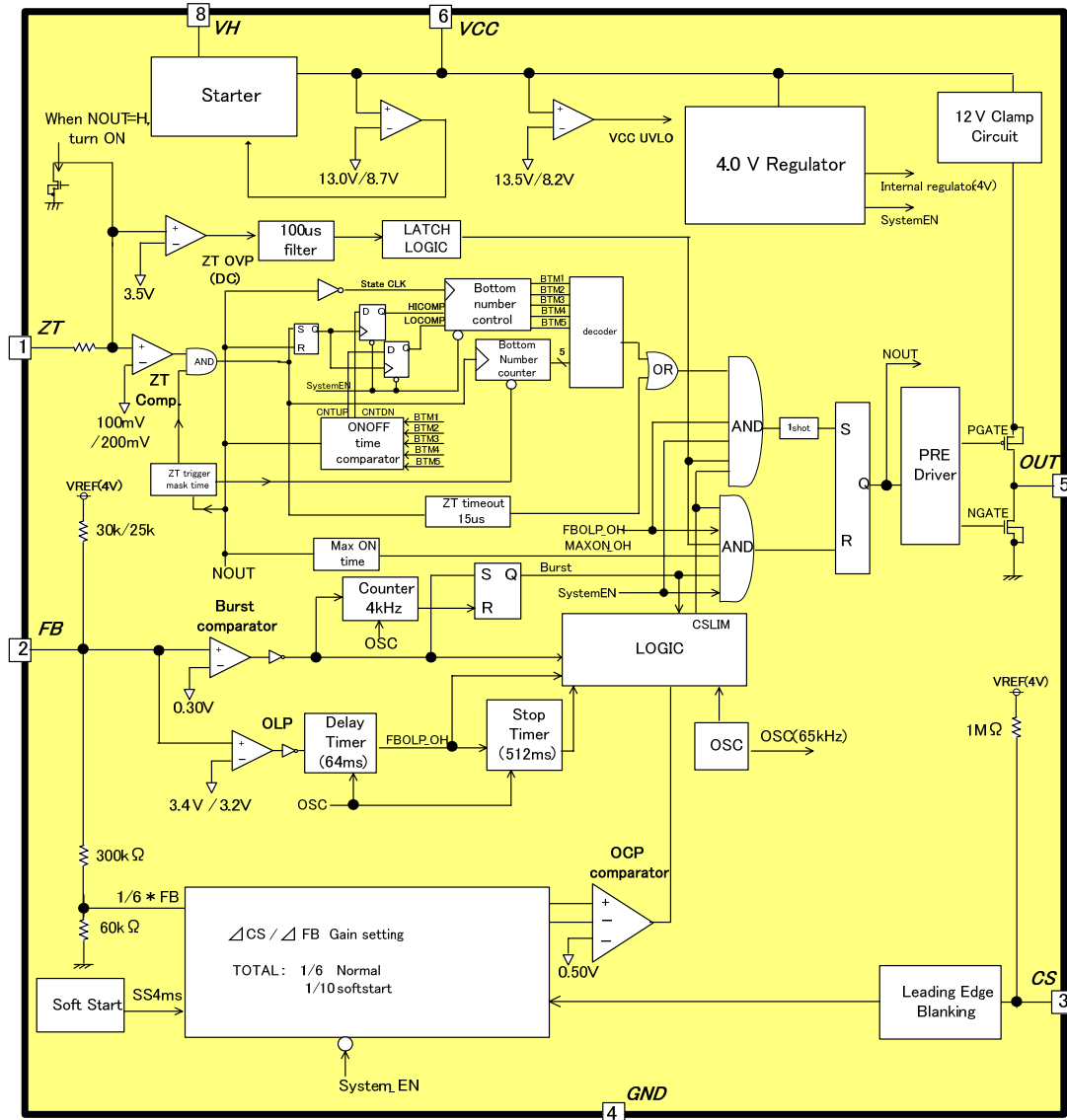


Figure 11. DC/DC 動作ブロック図

(1) ON 幅の決定 (ターンオフ)

ON 幅は、FB 端子(2pin)及び CS 端子(3pin)で制御します。

FB 端子電圧をゲイン倍 ($1/AV_{CS1}$ (typ=6))した電圧と CS 端子(3pin)電圧との比較により、ON 幅を決定します。

また、IC 内部で生成している V_{lim} との比較により、Figure 12.に示すように、リニアにコンパレータレベルを変化させます。

CS 端子(3pin)は、パルスごとの過電流リミッタ回路を兼用しています。

FB 端子(2pin)の変化により過電流リミッタレベルを変化させます。

・FB 電圧 < 0.3V : バースト動作 バースト解除時は $\Delta CS/\Delta FB$ ゲイン=1/6 で動作開始

・0.3V < FB 電圧 < 3.4V : $\Delta CS/\Delta FB$ ゲイン=1/ Av_{cs} =1/6 で動作

・3.4V < FB 電圧 : 過負荷動作 (過負荷状態を検知してパルス動作を止めます。)

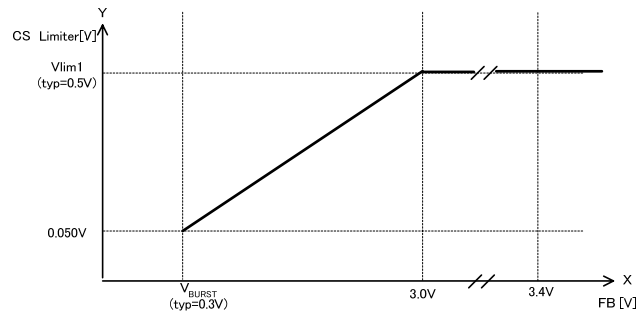


Figure 12. FB 端子電圧と過電流リミッタの関係
(通常動作[ゲイン:1/6])

ソフトスタート期間は過電流リミッタレベルが調整されます。

ソフトスタート中の過電流リミッタレベル V_{lim1} , V_{lim2} は下記のとおりになります。

Table-2 過電流保護電圧

ソフトスタート	V_{lim1}
起動 ~4ms	0.300V(60%)
4ms~	0.500V(100%)

(2) LEB (Leading Edge Blanking) 機能

スイッチング用 MOSFET が ON する際に、各容量成分や駆動電流などで、サージ電流が発生します。

そのため、一時的に CS 端子(3pin)電圧が上昇し、過電流リミッタ回路が誤検出する可能性があります。

誤検出防止用に、OUT 端子(5pin)が L→H と切り替わってから、 T_{LEB} (typ=250ns)間マスクをするブランキング機能が内蔵されています。このブランキング機能により、CS 端子(3pin)のノイズフィルタを削減できます。

(3) OFF 幅の決定(ターンオン)

ZT 端子(1pin)で OFF 幅の制御を行います。

ターン OFF している期間は、2 次側出力コンデンサへトランスに蓄えられた電力を供給します。

供給が終わると、2 次側に流れる電流はなくなるため、トランスと MOSFET の V_{ds} 間の容量による共振動作が始まります。

ZT 端子(1pin)にはこの共振波形を Rzt1 と Rzt2 で分圧された波形が入力されます。この電圧レベルが、 V_{ZT1} (typ=100mV)以下になると ZT コンパレータがボトムを検知します。一定のボトム数になると、ボトム検出時にターンオンします。

実際のボトムとコンパレータの検出時間は ZT 端子(1pin)に設定する Czt と Rzt1,Rzt2 の時定数で調整します。

また、ZT 端子には ZT トリガマスク機能(4-6 説明)、ZT タイムアウト機能(4-7 説明)が内蔵されています。

一定のボトム数について、以下に説明します。

本 IC は、負荷に応じてボトム数を変更します。ボトム数はトランスの充放電時間および入力電圧によって決定します。

Figure 13.に充放電時間の波形、Table-3 に AC 電圧、充放電時間、ボトム数を示します。Figure 14.に充放電時間に対するボトム数、負荷に対するスイッチング周波数例を示します。

$$\text{スイッチング周波数} = 1 / \{ \text{充放電時間} + (\text{ボトム数}-1) \times \text{共振時間} + 1/2 \times \text{共振時間} \}$$

$$\text{共振時間} = 2 \times \pi \times \sqrt{L_p \times C_{ds}}$$

* L_p :一次側インダクタンス値, MOSFET D-S 間容量値 C_{ds}

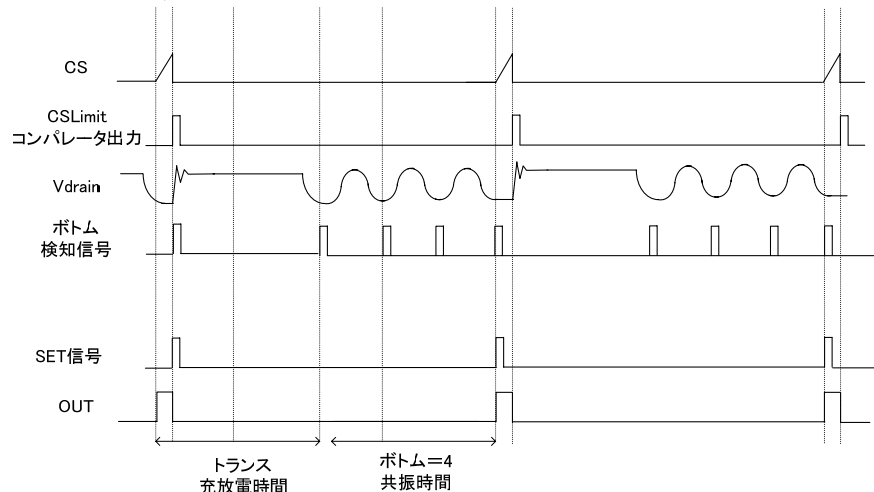


Figure 13. トランス充放電時間、ボトム時間

Table 3-1. ボトム数 – ON/OFF 幅表

○負荷増加時

ボトム数	充放電時間[us]
5	~ 8.6
4	8.6 ~ 10.0
3	10.0 ~ 11.7
2	11.7 ~ 14.0
1	14.0 ~

Table 3-2. ボトム数 – ON/OFF 幅表

○負荷減少時

ボトム数	充放電時間[us]
1	~ 9.0
2	8.0 ~ 9.0
3	7.0 ~ 8.0
4	6.0 ~ 7.0
5	~ 6.0

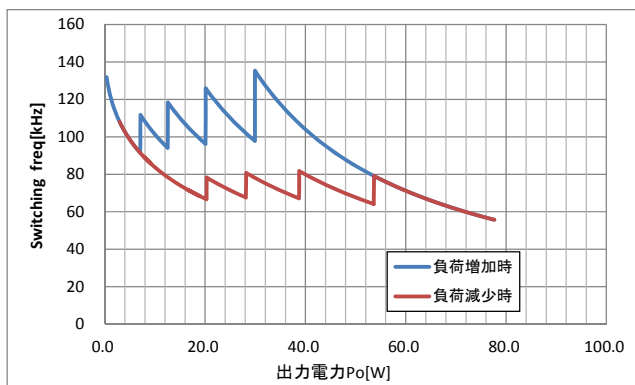


Figure 14-1. 出力電力 – スwitchング周波数特性例

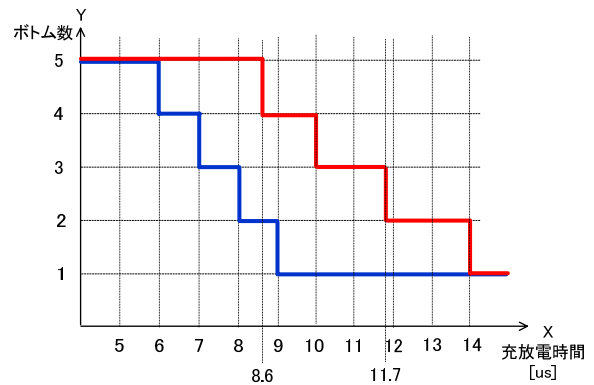


Figure 14-2. 充放電時間 – ボトム数特性

(4) バースト時モスキート音抑制機能

FB 端子(2pin)が $V_{BURST}(typ=0.3V)$ より低くなると、バースト機能によりスイッチング停止します。このとき、トランスの高音(モスキート音: 10kHz~20kHz)での音鳴きを抑制するためにモスキート音抑制機能を内蔵しており、バースト動作時にバースト周波数が 10kHz~20kHz に入らないように動作します。

この動作を Figure 15.に示します。この動作により、バースト時に出力する周波数スペクトルはバースト時のスイッチング周波数と4kHz(250us)以下のバースト周波数の基本波とその高調波となるため、トランスの高音(モスキート音)での音鳴き(10kHz~20kHz)が抑制されます。

またバースト時のモスキート音抑制動作について、Figure 15.に示します。

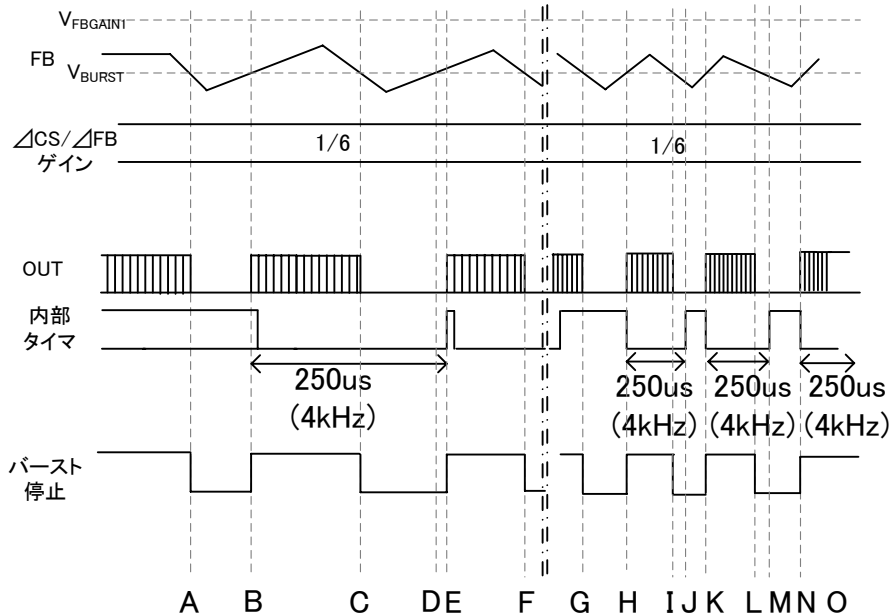


Figure 15. バースト時スイッチング動作

- A: 負荷が軽くなり、FB 端子電圧低下。FB 端子電圧 $<V_{BURST}(typ=0.3V)$ となり、スイッチング停止。
- B: スwitching開始から 250us($F=4kHz$)経過後にバースト FB 端子電圧 $>V_{BURST}(typ=0.3V)$ となり、スイッチング開始。
- C: FB 端子電圧 $<V_{BURST}(typ=0.3V)$ となり、スイッチング停止。
- D: FB 端子電圧 $>V_{BURST}(typ=0.3V)$ となるが、B 時点から 250us(バースト周波数 4kHz)経過していないため、スイッチングしない。
- E: B 時点のスイッチング開始から 250us 経過したため、スイッチング開始。
- F: FB 端子電圧 $<V_{BURST}(typ=0.3V)$ となり、スイッチング停止。
- G: FB 端子電圧 $<V_{BURST}(typ=0.3V)$ となり、スイッチング停止。
- H: 前回のスイッチング開始から 250us 経過後に FB 端子電圧 $>V_{BURST}(typ=0.3V)$ となるためスイッチング動作開始。
- I: FB 端子電圧 $<V_{BURST}(typ=0.3V)$ となり、スイッチング停止。
- J: H 時点から 250us 経過するが、FB 端子電圧 $<V_{BURST}(typ=0.3V)$ のため、スイッチングしない。
- K: FB 端子電圧 $>V_{BURST}(typ=0.3V)$ となるため、スイッチング開始。
- L: FB 端子電圧 $<V_{BURST}(typ=0.3V)$ となり、スイッチング停止。
- M: K 時点から 250us 経過するが、FB 端子電圧 $<V_{BURST}(typ=0.3V)$ のため、スイッチングしない。
- N: FB 端子電圧 $>V_{BURST}(typ=0.3V)$ となるため、スイッチング動作開始。

バースト周波数-負荷特性は Figure 16.になります。

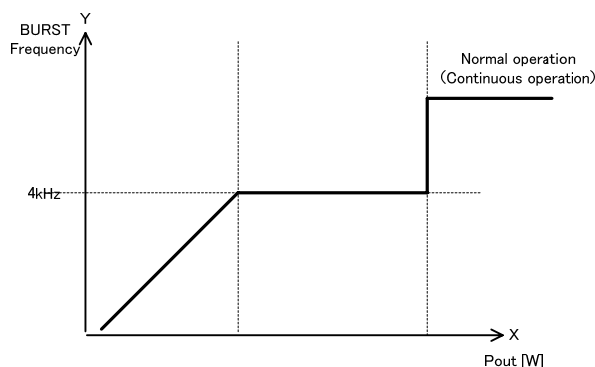


Figure 16. バースト周波数-負荷特性

(5) パースト時ゲイン増加機能

FB 端子(2pin)が $V_{BURST}(typ=0.3V)$ より低くなると、パースト機能によりスイッチング停止します。このとき、出力リップル電圧低減および音鳴り防止のために DC/DC のゲインを増加させる機能を内蔵しております。この機能は FB 端子プルアップ抵抗を $R_{FB1}(typ=30k\Omega) \rightarrow R_{FB2}(typ=25k\Omega)$ に切り替えることで達成されます。

DC/DC のゲインを変化させるため、パースト解除時の FB 端子電圧の挙動で発振等があるとき、FB 端子容量を大きくする必要があります。

この動作により、FB 電圧上昇が速くなります。FB 電圧が $V_{BSTCH}(typ=0.40V)$ よりも上昇したとき、ゲイン増加が解除されます。

この動作を Figure 17.に示します。

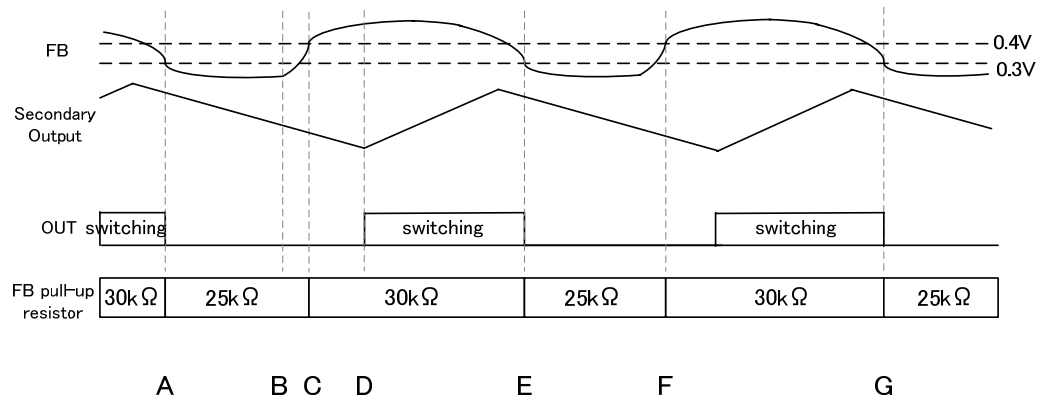


Figure 17. 軽負荷時ゲイン増加機能動作波形

- A: 負荷が軽くなり、FB 端子電圧 $< V_{BURST}(typ=0.3V)$ 以下に低下。
 FB 端子電圧 $< V_{BURST}(typ=0.3V)$ となり、スイッチング停止。
 このとき FB プルアップ抵抗 $R_{FB1}(typ=30k\Omega) \rightarrow R_{FB2}(typ=25k\Omega)$ に変化。
- B: 出力電圧がレギュレーション電圧に対して低下したため、FB 電圧が上昇を始める。
- C: FB 端子電圧 $> V_{BSTCH}(typ=0.4V)$ となり、FB プルアップ抵抗 $R_{FB2}(typ=25k\Omega) \rightarrow R_{FB1}(typ=30k\Omega)$ となり、ゲイン増加が解除される。
- D: 最大パースト周波数 F_{OSCB} 後にスイッチング開始。
- E: 負荷が軽くなり、FB 端子電圧 $< V_{BURST}(typ=0.3V)$ 以下に低下。
 FB 端子電圧 $< V_{BURST}(typ=0.3V)$ となり、スイッチング停止。
 このとき FB プルアップ抵抗 $R_{FB1}(typ=30k\Omega) \rightarrow R_{FB2}(typ=25k\Omega)$ に変化。
- F: FB 端子電圧 $> V_{BSTCH}(typ=0.4V)$ となり、FB プルアップ抵抗 $R_{FB2}(typ=25k\Omega) \rightarrow R_{FB1}(typ=30k\Omega)$ となり、ゲイン増加が解除される。

(6) ZTトリガマスク機能(Figure 18.)

ON⇒OFF スwitching時に、ZT 端子(1pin)にノイズが重畳することがあります。

その時、ZT コンパレータが誤動作しないように、 $T_{ZTMASK}(typ=2.0\mu s)$ の時間、ボトム検出を禁止します。

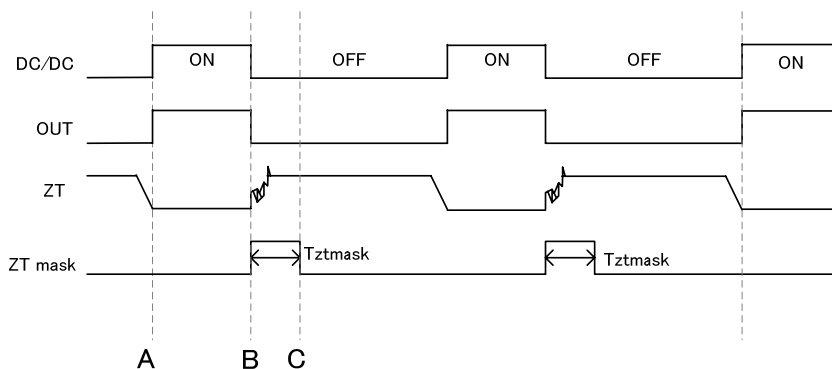


Figure 18. ZTトリガマスク機能

- A: DC/DC OFF⇒ON
 B: DC/DC ON⇒OFF
 C: ZT 端子にノイズが発生するため、 T_{ZTMASK} は、ZT コンパレータをマスクします。

(7) ZT タイムアウト機能 (Figure 19.)

ZT コンパレータ検出後、 T_{ZTOUT} (typ = 15 μ s) 経過しても、次の ZT 端子電圧が V_{ZT1} (typ=100mV) よりも低い場合、強制的にスイッチングを ON にする機能です。

起動時など、2 次側出力電圧が小さい時、補助巻線電圧 V_A も小さくなり、ZT 端子(1pin)電圧が V_{ZT2} (typ = 200mV) より低くなります。このような場合、強制的に ON する機能になります。

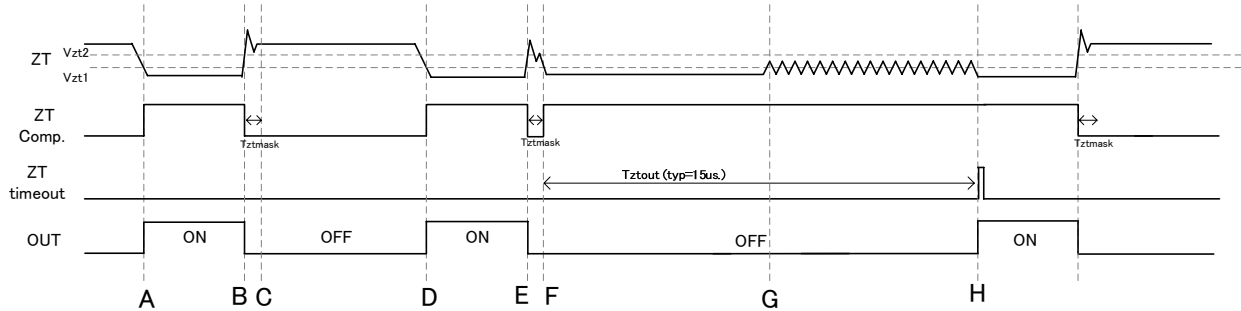


Figure 19. ZT タイムアウト機能

A: $ZT < V_{ZT1}$, ボトム検知により OUT を ON する。

B: DC/DC ON => OFF、 $ZT > V_{ZT2}$ の状態のため、タイムアウト機能は動作しない。

C: ZT 端子にノイズが発生するため、 T_{ZTMASK} 期間は、ZT コンパレータを動作させない。

D: $ZT < V_{ZT1}$, ボトム検知により OUT を ON する。

このとき、ZT コンパレータは H になるが、OUT=H のためタイムアウト機能は動作しない。

E: DC/DC ON => OFF このとき $ZT < V_{ZT2}$ となる。

F: $ZT < V_{ZT1}$ となり、ZT コンパレータ=H さらに OUT=L のため、この時点からタイムアウト機能が動作開始。

G: $ZT < V_{ZT2}$ の間はタイムアウト動作が続く。

H: T_{ZTOUT} の期間、 $ZT < V_{ZT2}$ の状態となったため、強制的に DC/DC OFF => ON (タイムアウト動作)

5. ソフトスタート動作

AC 電源投入時、出力電圧及び出力電流の大きな変化を防止するために、ソフトスタート機能を内蔵しています。

VCC 端子(6pin)が、 V_{UVLO2} (typ = 8.2V) 以下となった場合にリセットされ、次の AC 電源投入時にソフトスタートが実行されます。

ソフトスタートは、起動してから下記の動作を行います。((4)-1 ターンオフの項目を参照してください。)

・起動～4ms => CS リミッタ値をノーマル時の 60% に設定

・4ms～ => 通常動作

6. ZT 端子(1pin)OVP (Over Voltage Protection)

ZT 端子(1pin)には、OVP(Over Voltage Protection)機能が内蔵されています。ZT 端子 OVP 保護はラッチ方式です。

ZTOVP は ZT 端子に対して、DC 検知にのみ対応しております。

ノイズにより ZT 端子(1pin)OVP 機能が誤動作しないように、 T_{LATCH} (typ=100 μ s) タイマを内蔵しています。

7. CS 端子(3pin)オープン保護

CS 端子(3pin)が OPEN になった場合、ノイズにより OUT 端子(5pin)が誤動作しないために、CS 端子(3pin)オープン保護回路が内蔵されています。この機能により CS 端子(3pin)がオープン時は OUT 端子(5pin)のスイッチングを停止します。(自己復帰保護)

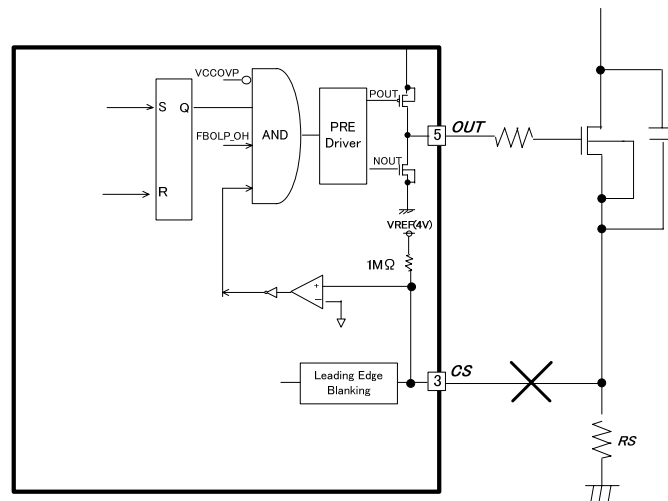


Figure 20. CS オープン保護回路

8. 出力過負荷保護機能 (FB OLP コンパレータ)

過負荷保護機能とは、2 次側出力の過負荷状態を FB 端子(2pin)でモニタし、過負荷状態時に OUT 端子(5pin)を L 固定します。

過負荷状態では、出力電圧が低下するためフォトカプラに電流が流れなくなり、FB 端子(2pin)は持ち上がります。

この状態が T_{FOLP} (typ = 64ms) 間続いたら、過負荷状態と判断して、OUT 端子 (5pin) を L に固定します。

FB 端子 (2pin) が V_{FOLP1A} (typ = 3.4V) を超えてから、 T_{FOLP} (typ = 64ms) 以内に V_{FOLP1B} (typ = 3.2V) よりも低下した場合は、過負荷保護タイマーがリセットされます。

起動時、FB 端子は内部電圧に抵抗プルアップされているため、 V_{FOLP1A} (typ = 3.4V) 以上の電圧から動作します。

そのため、2 次側出力電圧の起動時間は、IC が起動してから、 T_{FOLP} (typ = 64ms) 以内に設定してください。

過負荷検出後 IC は T_{OLPST} (typ = 512ms) 停止し、その後自己復帰動作します。停止時、VCC 電圧は低下しますが、起動回路により VCC 電圧を充電されるため、VCC 端子電圧 > V_{UVLO2} を保ちます。

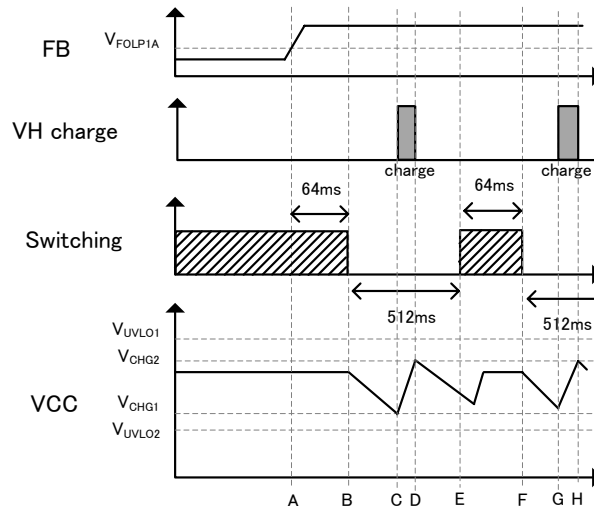


Figure 21. 過負荷保護 自己復帰

A: $FB > V_{FOLP1A}$ のため、FBOLP コンパレータが過負荷を検出。

B: A の状態が T_{FOLP} (typ = 64ms) の期間続くと、過負荷保護により、スイッチングを停止します、

C: 過負荷保護によりスイッチング停止中、VCC 電圧(6pin)が低下して VCC 端子 (6pin) 電圧 < V_{CHG1} になると VCC 充電機能が動作して VCC 端子 (6pin) 電圧を上昇します。

D: VCC 充電機能により VCC 端子 (6pin) 電圧 > V_{CHG2} になると VCC 充電機能が停止します。

E: B の時点から T_{OLPST} (typ = 512ms) が経過すると、ソフトスタート動作でスイッチングを開始します。

F: 過負荷状態が続いている場合は $FB > V_{FOLP1A}$ の状態が続き、E の時点から T_{FOLP} (typ = 64ms) の期間経過するとスイッチングを停止します。

G: スwitchング停止中、VCC 電圧(6pin)が低下して VCC 端子 (6pin) 電圧 < V_{CHG1} になると VCC 充電機能が動作して、VCC 端子 (6pin) 電圧を上昇します。

H: VCC 充電機能により VCC 端子 (6pin) 電圧 > V_{CHG2} になると VCC 充電機能が停止します。

9. OUT 端子(5pin) クランプ機能

外付け MOSFET を保護する目的で、OUT 端子 (5pin) の H レベルを V_{OUTH} (typ = 12.5V) にクランプします。

VCC 端子 (6pin) 電圧の上昇による、MOSFET ゲート破壊を防ぎます。(Figure 22.に示す。)

OUT 端子 (5pin) には内部で R_{PDOUT} (typ = 100k Ω) プルダウンをしています。

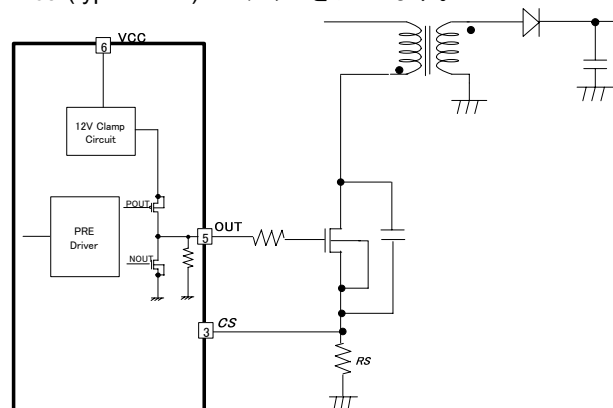


Figure 22. OUT 端子(5pin) 概略図

●保護回路の動作モード

各保護機能の動作モードを Table4 に示します。

項目	保護動作モード
VCC Under Voltage Locked Out	自己復帰
FB Over Load Protection	自己復帰(64ms遅延, 512ms停止)
CS Open Protection	自己復帰
ZT Over Voltage Protection	ラッチ(100us タイマー付き)
VCC Charge Protection	自己復帰

●熱損失について

熱設計において、次の条件内で動作させてください。
 (下記温度は保証温度ですので、必ずマージンなどを考慮してください。)

1. 周囲の温度 Ta が 85℃以下であること。
2. IC の損失が許容損失 Pd 以下であること。

熱軽減特性は次の通りです。(Figure 23.)

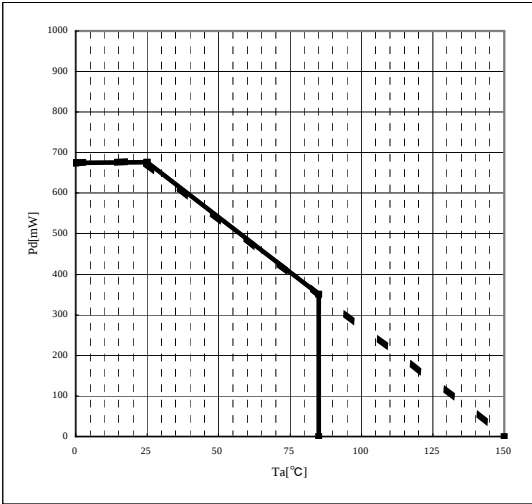


Figure 23. SOP-J8 熱軽減特性

●特性データ(あくまでも参照データであり、保証するものではありません。)

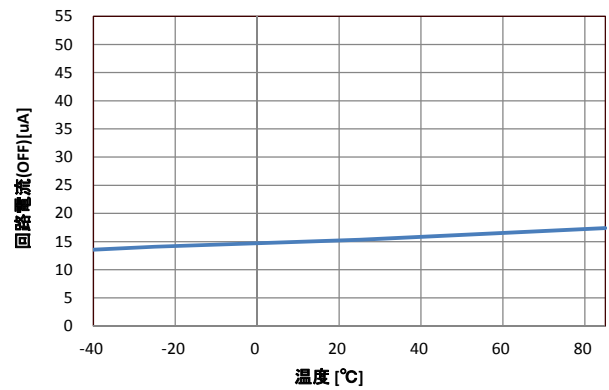


Figure 24 回路電流(OFF) vs 温度

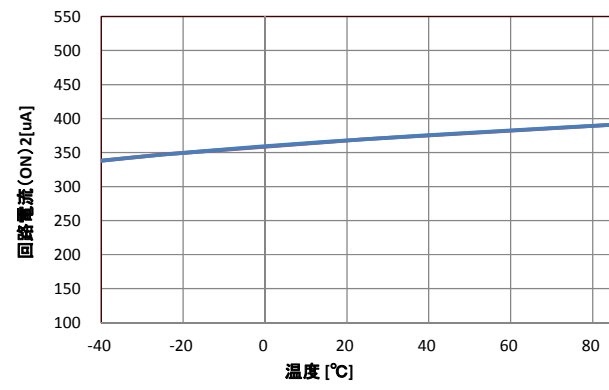


Figure 25 回路電流(ON)2 vs 温度

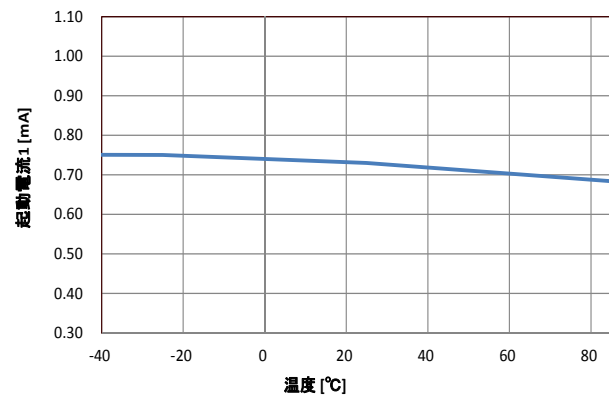


Figure 26 起動電流 1 vs 温度

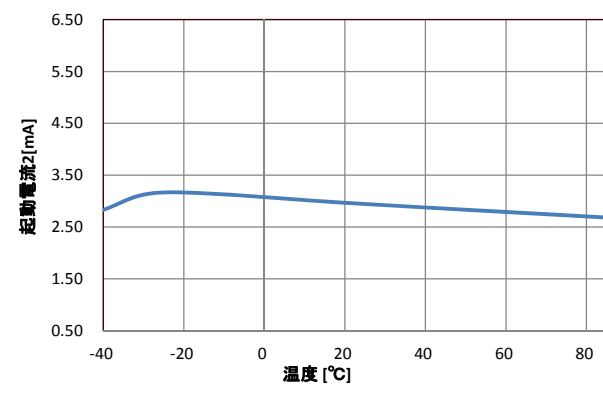


Figure 27 起動電流 2 vs 温度

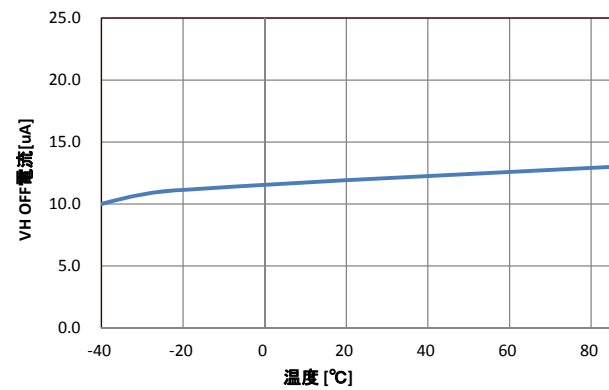


Figure 28 VH OFF 電流 vs 温度

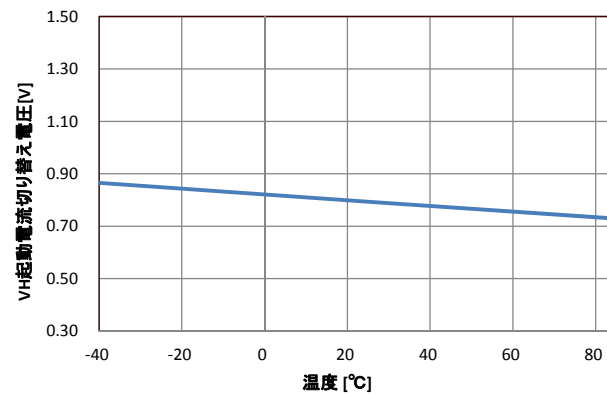


Figure 29 VH 起動電流切り替え電圧 vs 温度

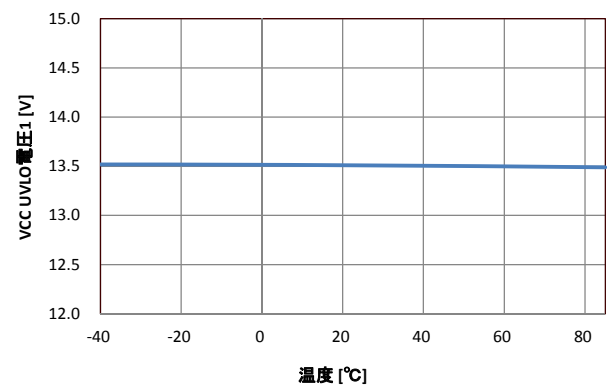


Figure 30 VCC UVLO 電圧 1 vs 温度

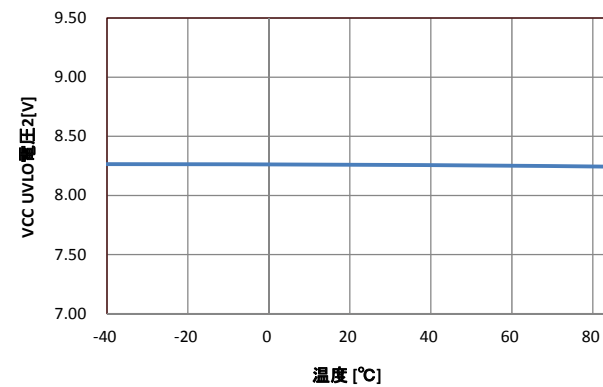


Figure 31 VCC UVLO 電圧 2 vs 温度

●特性データ(あくまでも参照データであり、保証するものではありません。)

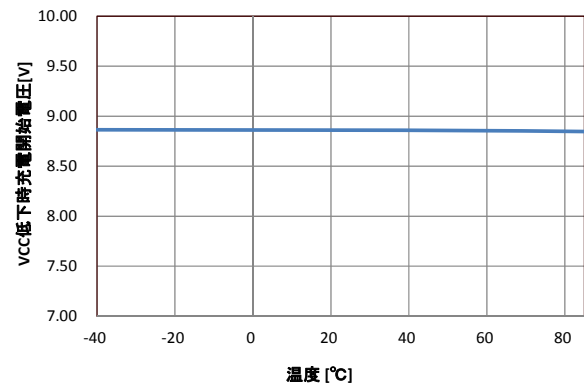


Figure 32 VCC 低下時充電開始電圧 vs 温度

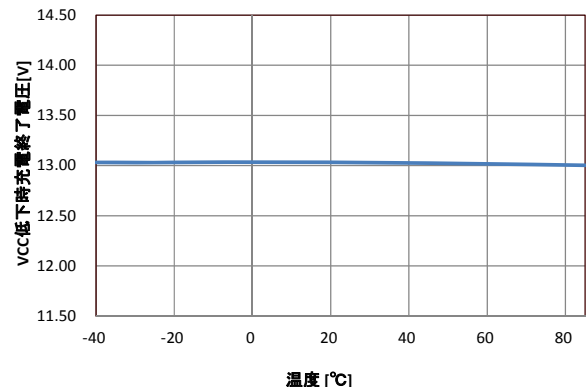


Figure 33 VCC 充電終了電圧 vs 温度

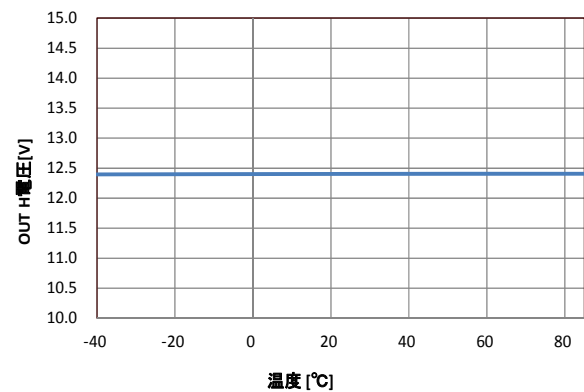


Figure 34 OUT H 電圧 vs 温度

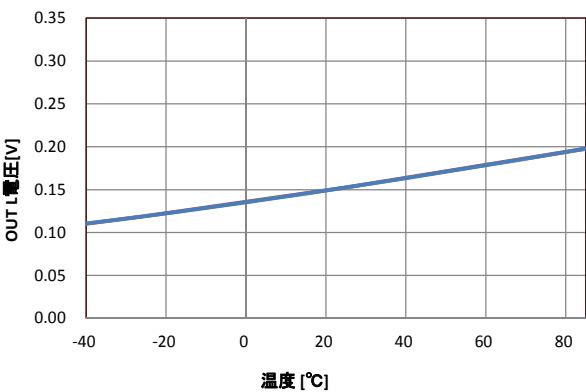


Figure 35 OUT L 電圧 vs 温度

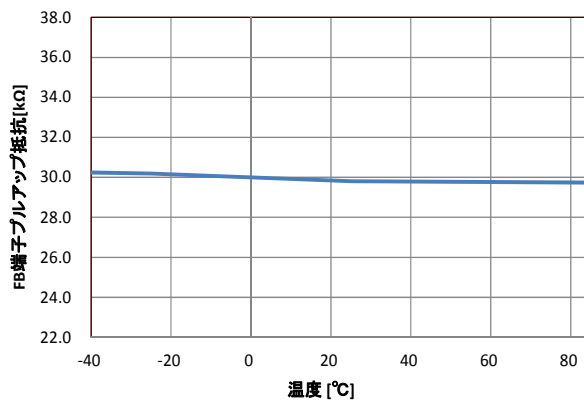


Figure 36 FB 端子プルアップ抵抗 vs 温度

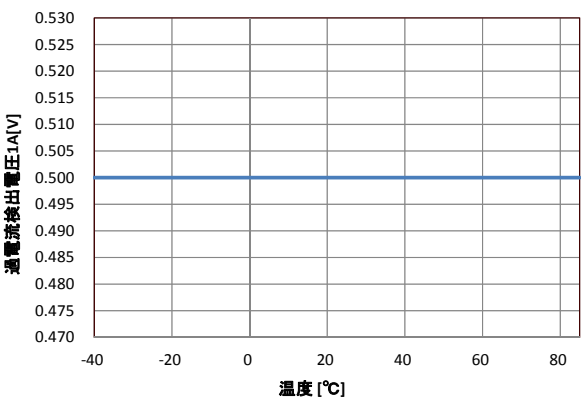


Figure 37 過電流検出電圧 1A vs 温度

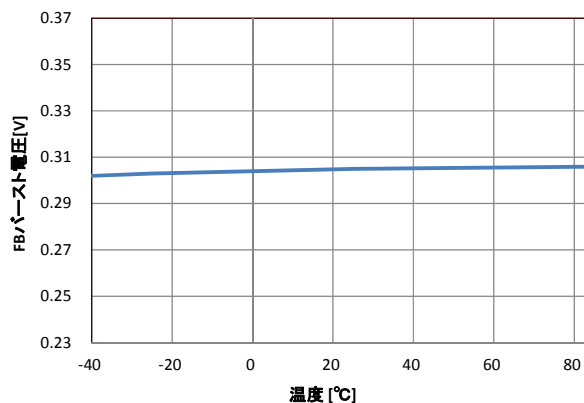


Figure 38 FB バースト電圧 vs 温度

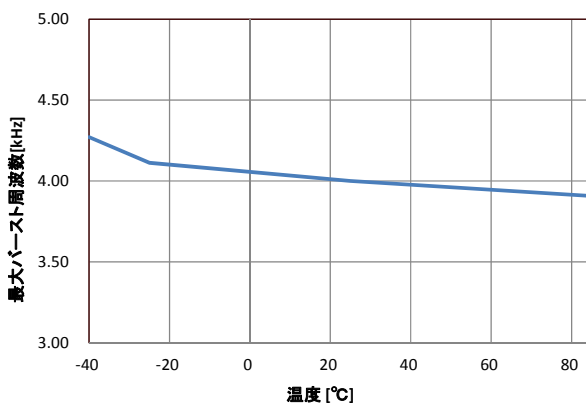


Figure 39 最大バースト周波数 vs 温度

●特性データ(あくまでも参照データであり、保証するものではありません。)

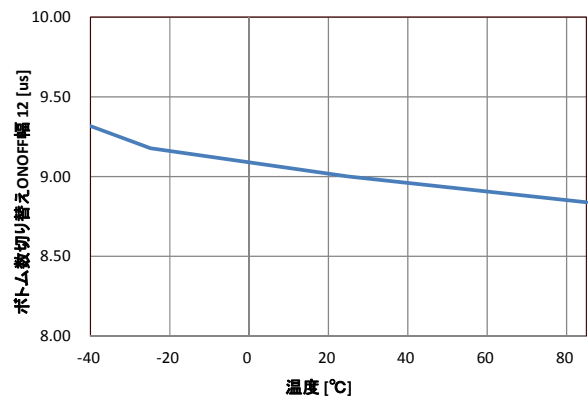


Figure 40 ボトム数切り替え ONOFF 幅 12 vs 温度

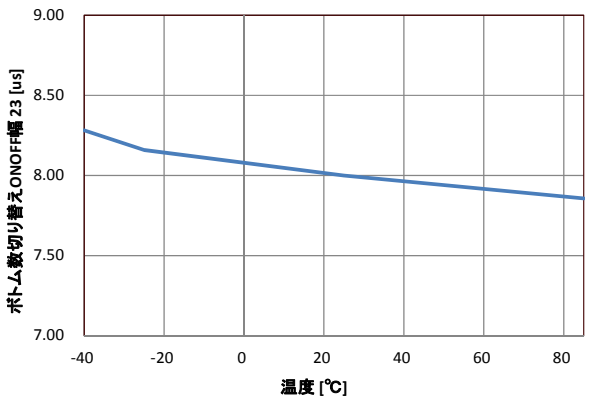


Figure 41 ボトム数切り替え ONOFF 幅 23 vs 温度

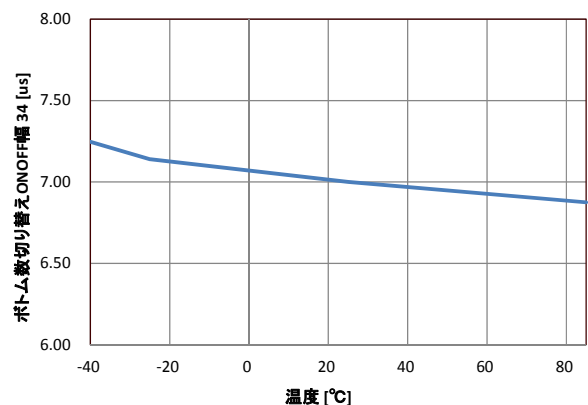


Figure 42 ボトム数切り替え ONOFF 幅 34 vs 温度

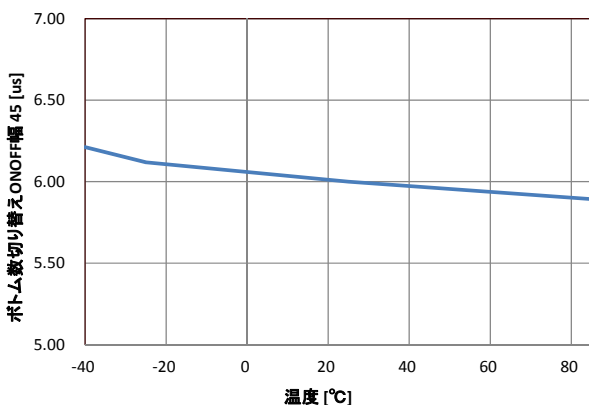


Figure 43 ボトム数切り替え ONOFF 幅 45 vs 温度

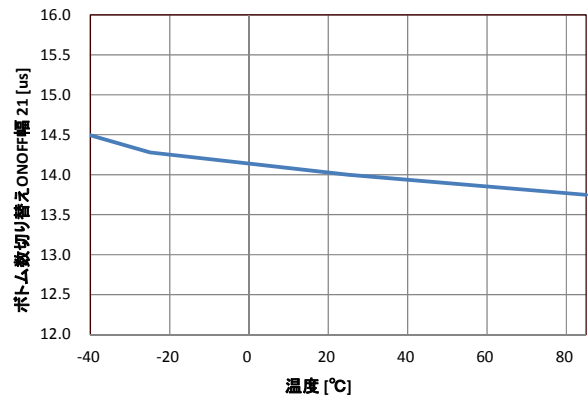


Figure 44 ボトム数切り替え ONOFF 幅 21 vs 温度

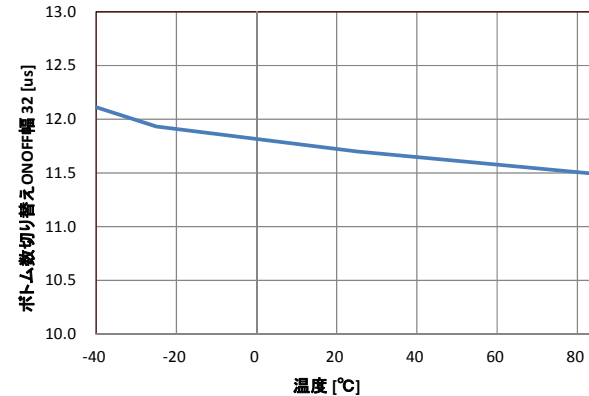


Figure 45 ボトム数切り替え ONOFF 幅 32 vs 温度

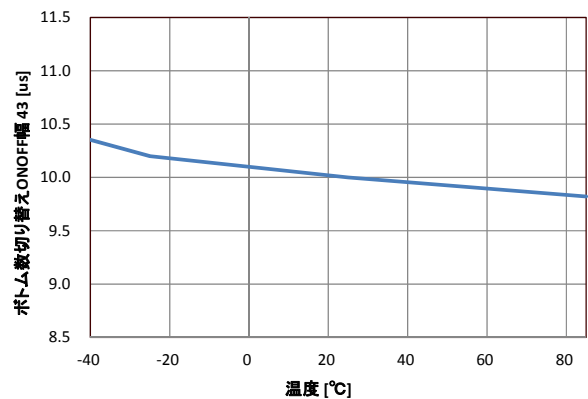


Figure 46 ボトム数切り替え ONOFF 幅 43 vs 温度

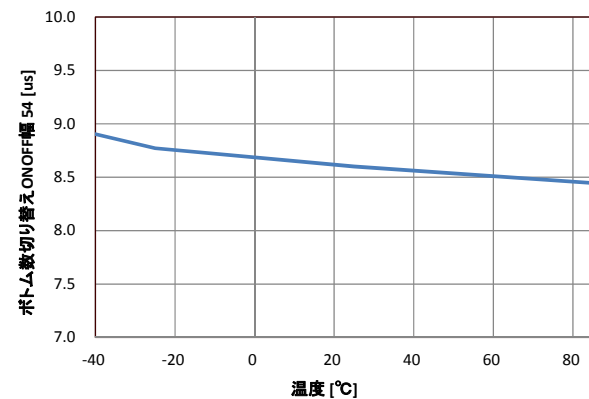


Figure 47 ボトム数切り替え ONOFF 幅 54 vs 温度

●特性データ(あくまでも参照データであり、保証するものではありません。)

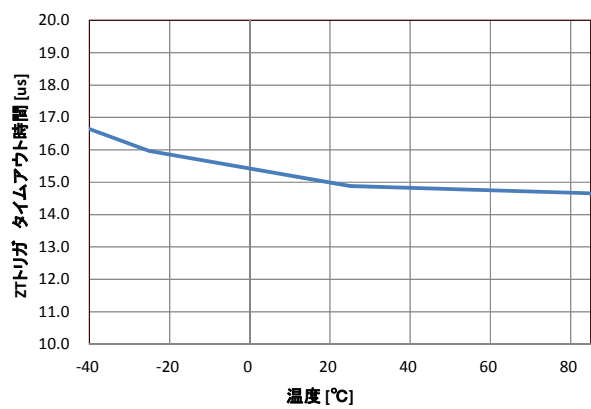


Figure 48 ZTトリガ タイムアウト時間 vs 温度

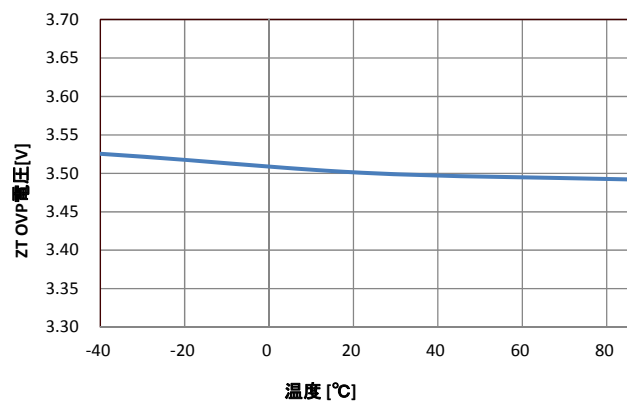


Figure 49 ZT OVP 電圧 vs 温度

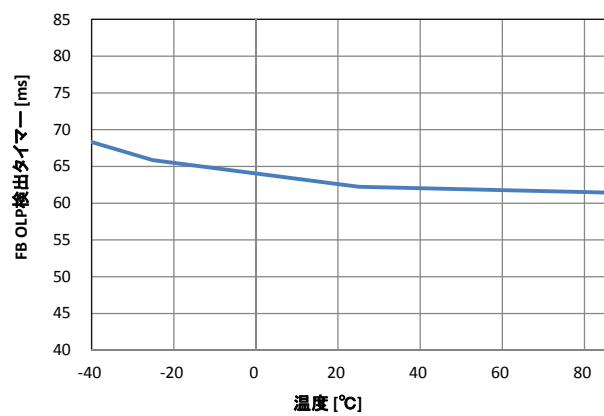


Figure 50 FBOLP 検出タイマー vs 温度

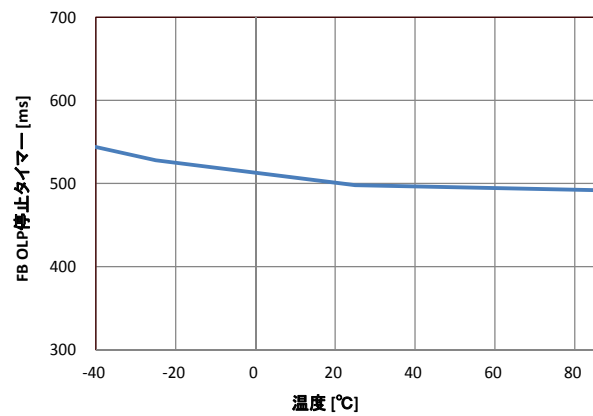


Figure 51 FBOLP 停止タイマー vs 温度

使用上の注意

1. 電源の逆接続について

電源コネクタの逆接続により LSI が破壊する恐れがあります。逆接続破壊保護用として外部に電源と LSI の電源端子間にダイオードを入れる等の対策を施してください。

2. 電源ラインについて

基板パターンの設計においては、電源ラインの配線は、低インピーダンスになるようにしてください。その際、デジタル系電源とアナログ系電源は、それらが同電位であっても、デジタル系電源パターンとアナログ系電源パターンは分離し、配線パターンの共通インピーダンスによるアナログ電源へのデジタル・ノイズの回り込みを抑止してください。グラウンドラインについても、同様のパターン設計を考慮してください。

また、LSI のすべての電源端子について電源-グラウンド端子間にコンデンサを挿入するとともに、電解コンデンサ使用の際は、低温で容量ぬけが起こることなど使用するコンデンサの諸特性に問題ないことを十分ご確認のうえ、定数を決定してください。

3. グラウンド電位について

グラウンド端子の電位はいかなる動作状態においても、最低電位になるようにしてください。また実際に過渡現象を含め、グラウンド端子以外のすべての端子がグラウンド以下の電圧にならないようにしてください。

4. グラウンド配線パターンについて

小信号グラウンドと大電流グラウンドがある場合、大電流グラウンドパターンと小信号グラウンドパターンは分離し、パターン配線の抵抗分と大電流による電圧変化が小信号グラウンドの電圧を変化させないように、セットの基準点で 1 点アースすることを推奨します。外付け部品のグラウンドの配線パターンも変動しないよう注意してください。グラウンドラインの配線は、低インピーダンスになるようにしてください。

5. 熱設計について

万一、許容損失を超えるようなご使用をされますと、チップ温度上昇により、IC 本来の性質を悪化させることにつながります。本仕様書の絶対最大定格に記載しています許容損失は、70mm x 70mm x 1.6mm ガラスエポキシ基板実装時、放熱板なし時の値であり、これを超える場合は基板サイズを大きくする、放熱用銅箔面積を大きくする、放熱板を使用する等の対策をして、許容損失を超えないようにしてください。

6. 推奨動作条件について

この範囲であればほぼ期待通りの特性を得ることが出来る範囲です。電気特性については各項目の条件下において保証されるものです。推奨動作範囲内であっても電圧、温度特性を示します。

7. ラッシュカレントについて

IC 内部論理回路は、電源投入時に論理不定状態で、瞬間的にラッシュカレントが流れる場合がありますので、電源カップリング容量や電源、グラウンドパターン配線の幅、引き回しに注意してください。

8. 強電磁界中の動作について

強電磁界中でのご使用では、まれに誤動作する可能性がありますのでご注意ください。

9. セット基板での検査について

セット基板での検査時に、インピーダンスの低いピンにコンデンサを接続する場合は、IC にストレスがかかる恐れがあるので、1 工程ごとに必ず放電を行ってください。静電気対策として、組立工程にはアースを施し、運搬や保存の際には十分ご注意ください。また、検査工程での治具への接続をする際には必ず電源を OFF にしてから接続し、電源を OFF にしてから取り外してください。

10. 端子間ショートと誤装着について

プリント基板に取り付ける際、IC の向きや位置ずれに十分注意してください。誤って取り付けした場合、IC が破壊する恐れがあります。また、出力と電源およびグラウンド間、出力間に異物が入るなどしてショートした場合についても破壊の恐れがあります。

使用上の注意 — 続き

11. 未使用の入力端子の処理について

CMOS トランジスタの入力は非常にインピーダンスが高く、入力端子をオープンにすることで論理不定の状態になります。これにより内部の論理ゲートの p チャネル、n チャネルトランジスタが導通状態となり、不要な電源電流が流れます。また 論理不定により、想定外の動作をすることがあります。よって、未使用の端子は特に仕様書上でうたわれていない限り、適切な電源、もしくはグラウンドに接続するようにしてください。

12. 各入力端子について

本 IC はモノリシック IC であり、各素子間に素子分離のための P+アイソレーションと、P 基板を有しています。

この P 層と各素子の N 層とで P-N 接合が形成され、各種の寄生素子が構成されます。

例えば、下図のように、抵抗とトランジスタが端子と接続されている場合、

○抵抗では、 $GND > (\text{端子 A})$ の時、トランジスタ (NPN) では $GND > (\text{端子 B})$ の時、P-N 接合が寄生ダイオードとして動作します。

○また、トランジスタ (NPN) では、 $GND > (\text{端子 B})$ の時、前述の寄生ダイオードと近接する他の素子の N 層によって寄生の NPN トランジスタが動作します。

IC の構造上、寄生素子は電位関係によって必然的にできます。寄生素子が動作することにより、回路動作の干渉を引き起こし、誤動作、ひいては破壊の原因ともなり得ます。したがって、入出力端子に GND (P 基板) より低い電圧を印加するなど、寄生素子が動作するような使い方をしないよう十分に注意してください。アプリケーションにおいて電源端子と各端子電圧が逆になった場合、内部回路または素子を損傷する可能性があります。例えば、外付けコンデンサに電荷がチャージされた状態で、電源端子が GND にショートされた場合などです。また、電源端子直列に逆流防止のダイオードもしくは各端子と電源端子間にバイパスのダイオードを挿入することを推奨します。

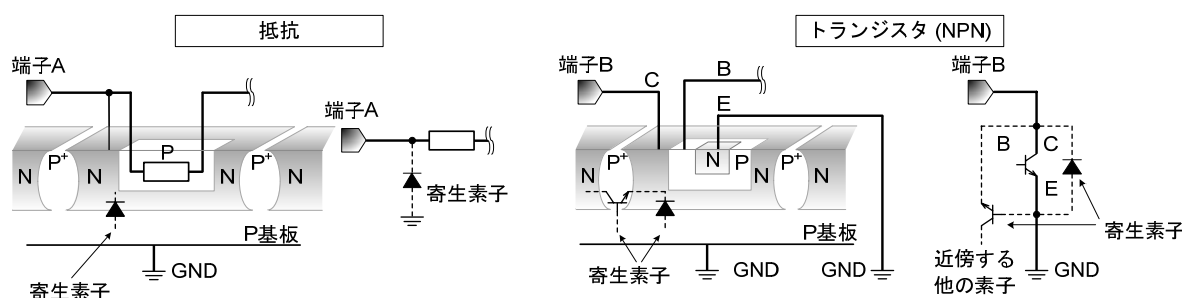


Figure 52. モノリシック IC 構造例

13. セラミック・コンデンサの特性変動について

外付けコンデンサに、セラミック・コンデンサを使用する場合、直流バイアスによる公称容量の低下、及び温度などによる容量の変化を考慮の上定数を決定してください。

14. 安全動作領域について

本製品を使用する際には、出力トランジスタが絶対最大定格及び ASO を越えないよう設定してください。

15. 温度保護回路について

IC を熱破壊から防ぐための温度保護回路を内蔵しております。許容損失範囲内でご使用いただきますが、万が一許容損失を超えた状態が継続すると、チップ温度 T_j が上昇し温度保護回路が動作し出力パワー素子が OFF します。その後チップ温度 T_j が低下すると回路は自動で復帰します。なお、温度保護回路は絶対最大定格を超えた状態での動作となりますので、温度保護回路を使用したセット設計等は、絶対に避けてください。

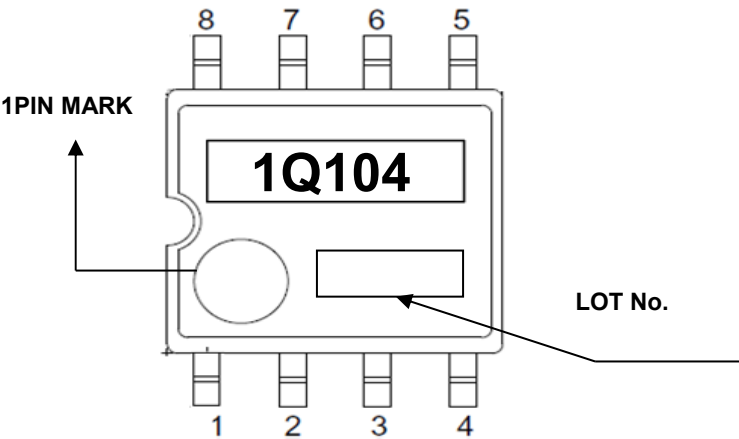
16. 過電流保護回路について

出力には電流能力に応じた過電流保護回路が内部に内蔵されているため、負荷ショート時には IC 破壊を防止しますが、この保護回路は突発的な事故による破壊防止に有効なもので、連続的な保護回路動作、過渡時でのご使用に対応するものではありません。

●発注形名情報

B M 1 Q 1 0 4 F J								-	E 2	
形名								パッケージ	包装、フォーミング仕様	
								F J : SOP-J8	E2: リール状エンボステープニング	

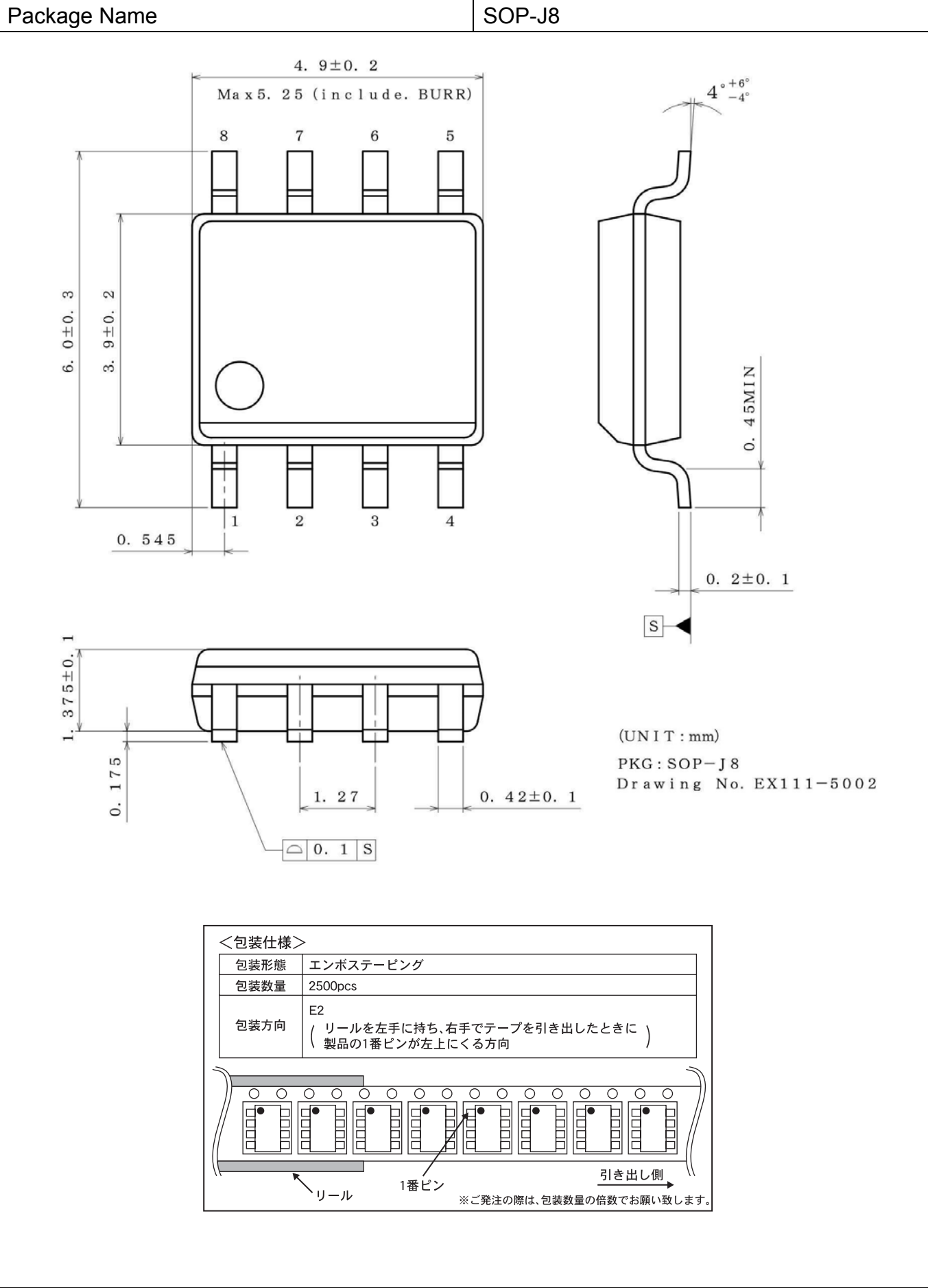
●標印図



●ラインアップ

形名(BM1Q10XFJ)
BM1Q104FJ

●外形寸法図と包装・フォーミング仕様



●改訂履歴

日付	版	変更内容
2014.3.31	001	新規作成
2014.5.20	001	新規登録
2017.7.5	002	P-1, P-2 推奨 VCC 電圧範囲変更, P-9 注意分追記
2017.7.13	002	電気的特性 I _{cc} (OFF)追加、特性データ追加

ご注意

ローム製品取扱い上の注意事項

1. 本製品は一般的な電子機器（AV 機器、OA 機器、通信機器、家電製品、アミューズメント機器等）への使用を意図して設計・製造されております。したがって、極めて高度な信頼性が要求され、その故障や誤動作が人の生命、身体への危険もしくは損害、又はその他の重大な損害の発生に関わるような機器又は装置（医療機器^(Note 1)、輸送機器、交通機器、航空宇宙機器、原子力制御装置、燃料制御、カーアクセサリを含む車載機器、各種安全装置等）（以下「特定用途」という）への本製品のご使用を検討される際は事前にローム営業窓口までご相談くださいますようお願い致します。ロームの文書による事前の承諾を得ることなく、特定用途に本製品を使用したことによりお客様又は第三者に生じた損害等に関し、ロームは一切その責任を負いません。

(Note 1) 特定用途となる医療機器分類

日本	USA	EU	中国
CLASS III	CLASS III	CLASS II b	Ⅲ類
CLASS IV		CLASS III	

2. 半導体製品は一定の確率で誤動作や故障が生じる場合があります。万が一、かかる誤動作や故障が生じた場合であっても、本製品の不具合により、人の生命、身体、財産への危険又は損害が生じないように、お客様の責任において次の例に示すようなフェールセーフ設計など安全対策をお願い致します。
 - ①保護回路及び保護装置を設けてシステムとしての安全性を確保する。
 - ②冗長回路等を設けて単一故障では危険が生じないようにシステムとしての安全を確保する。
3. 本製品は、一般的な電子機器に標準的な用途で使用されることを意図して設計・製造されており、下記に例示するような特殊環境での使用を配慮した設計はなされておられません。したがって、下記のような特殊環境での本製品のご使用に関し、ロームは一切その責任を負いません。本製品を下記のような特殊環境でご使用される際は、お客様におかれまして十分に性能、信頼性等をご確認ください。
 - ①水・油・薬液・有機溶剤等の液体中でのご使用
 - ②直射日光・屋外暴露、塵埃中でのご使用
 - ③潮風、Cl₂、H₂S、NH₃、SO₂、NO₂ 等の腐食性ガスの多い場所でのご使用
 - ④静電気や電磁波の強い環境でのご使用
 - ⑤発熱部品に近接した取付け及び当製品に近接してビニール配線等、可燃物を配置する場合。
 - ⑥本製品を樹脂等で封止、コーティングしてのご使用。
 - ⑦はんだ付けの後に洗浄を行わない場合（無洗浄タイプのフラックスを使用された場合も、残渣の洗浄は確実にを行うことをお勧め致します）、又ははんだ付け後のフラックス洗浄に水又は水溶性洗浄剤をご使用の場合。
 - ⑧本製品が結露するような場所でのご使用。
4. 本製品は耐放射線設計はなされておられません。
5. 本製品単体品の評価では予測できない症状・事態を確認するためにも、本製品のご使用にあたってはお客様製品に実装された状態での評価及び確認をお願い致します。
6. パルス等の過渡的な負荷（短時間での大きな負荷）が加わる場合は、お客様製品に本製品を実装した状態で必ずその評価及び確認の実施をお願い致します。また、定常時での負荷条件において定格電力以上の負荷を印加されますと、本製品の性能又は信頼性が損なわれるおそれがあるため必ず定格電力以下でご使用ください。
7. 電力損失は周囲温度に合わせてディレーティングしてください。また、密閉された環境下でご使用の場合は、必ず温度測定を行い、最高接合部温度を超えていない範囲であることをご確認ください。
8. 使用温度は納入仕様書に記載の温度範囲内であることをご確認ください。
9. 本資料の記載内容を逸脱して本製品をご使用されたことによって生じた不具合、故障及び事故に関し、ロームは一切その責任を負いません。

実装及び基板設計上の注意事項

1. ハロゲン系（塩素系、臭素系等）の活性度の高いフラックスを使用する場合、フラックスの残渣により本製品の性能又は信頼性への影響が考えられますので、事前にお客様にてご確認ください。
2. はんだ付けは、表面実装製品の場合リフロー方式、挿入実装製品の場合フロー方式を原則とさせていただきます。なお、表面実装製品をフロー方式での使用をご検討の際は別途ロームまでお問い合わせください。
その他、詳細な実装条件及び手はんだによる実装、基板設計上の注意事項につきましては別途、ロームの実装仕様書をご確認ください。

応用回路、外付け回路等に関する注意事項

1. 本製品の外付け回路定数を変更してご使用になる際は静特性のみならず、過渡特性も含め外付け部品及び本製品のバラツキ等を考慮して十分なマージンをみて決定してください。
2. 本資料に記載された応用回路例やその定数などの情報は、本製品の標準的な動作や使い方を説明するためのもので、実際に使用する機器での動作を保証するものではありません。したがって、お客様の機器の設計において、回路やその定数及びこれらに関連する情報を使用する場合には、外部諸条件を考慮し、お客様の判断と責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様又は第三者に生じた損害に関し、ロームは一切その責任を負いません。

静電気に対する注意事項

本製品は静電気に対して敏感な製品であり、静電放電等により破壊することがあります。取り扱い時や工程での実装時、保管時において静電気対策を実施のうえ、絶対最大定格以上の過電圧等が印加されないようにご使用ください。特に乾燥環境下では静電気が発生しやすくなるため、十分な静電対策を実施ください。（人体及び設備のアース、帯電物からの隔離、イオナイザの設置、摩擦防止、温湿度管理、はんだごてのこて先のアース等）

保管・運搬上の注意事項

1. 本製品を下記の環境又は条件で保管されますと性能劣化やはんだ付け性等の性能に影響を与えるおそれがありますのでこのような環境及び条件での保管は避けてください。
 - ①潮風、Cl₂、H₂S、NH₃、SO₂、NO₂等の腐食性ガスの多い場所での保管
 - ②推奨温度、湿度以外での保管
 - ③直射日光や結露する場所での保管
 - ④強い静電気が発生している場所での保管
2. ロームの推奨保管条件下におきましても、推奨保管期限を経過した製品は、はんだ付け性に影響を与える可能性があります。推奨保管期限を経過した製品は、はんだ付け性を確認したうえでご使用頂くことを推奨します。
3. 本製品の運搬、保管の際は梱包箱を正しい向き（梱包箱に表示されている天面方向）で取り扱ってください。天面方向が遵守されずに梱包箱を落下させた場合、製品端子に過度なストレスが印加され、端子曲がり等の不具合が発生する危険があります。
4. 防湿梱包を開封した後は、規定時間内にご使用ください。規定時間を経過した場合はベーク処置を行ったうえでご使用ください。

製品ラベルに関する注意事項

本製品に貼付されている製品ラベルに2次元バーコードが印字されていますが、2次元バーコードはロームの社内管理のみを目的としたものです。

製品廃棄上の注意事項

本製品を廃棄する際は、専門の産業廃棄物処理業者にて、適切な処置をしてください。

外国為替及び外国貿易法に関する注意事項

本製品は外国為替及び外国貿易法に定める規制貨物等に該当するおそれがありますので輸出する場合には、ロームにお問い合わせください。

知的財産権に関する注意事項

1. 本資料に記載された本製品に関する応用回路例、情報及び諸データは、あくまでも一例を示すものであり、これらに関する第三者の知的財産権及びその他の権利について権利侵害がないことを保証するものではありません。
2. ロームは、本製品とその他の外部素子、外部回路あるいは外部装置等（ソフトウェア含む）との組み合わせに起因して生じた紛争に関して、何ら義務を負うものではありません。
3. ロームは、本製品又は本資料に記載された情報について、ロームもしくは第三者が所有又は管理している知的財産権その他の権利の実施又は利用を、明示的にも黙示的にも、お客様に許諾するものではありません。ただし、本製品を通常の用法にて使用される限りにおいて、ロームが所有又は管理する知的財産権を利用されることを妨げません。

その他の注意事項

1. 本資料の全部又は一部をロームの文書による事前の承諾を得ることなく転載又は複製することを固くお断り致します。
2. 本製品をロームの文書による事前の承諾を得ることなく、分解、改造、改変、複製等しないでください。
3. 本製品又は本資料に記載された技術情報を、大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用、あるいはその他軍事用途目的で使用しないでください。
4. 本資料に記載されている社名及び製品名等の固有名詞は、ローム、ローム関係会社もしくは第三者の商標又は登録商標です。

一般的な注意事項

1. 本製品をご使用になる前に、本資料をよく読み、その内容を十分に理解されるようお願い致します。本資料に記載される注意事項に反して本製品をご使用されたことによって生じた不具合、故障及び事故に関し、ロームは一切その責任を負いませんのでご注意願います。
2. 本資料に記載の内容は、本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。本製品のご購入及びご使用に際しては、事前にローム営業窓口で最新の情報をご確認ください。
3. ロームは本資料に記載されている情報は誤りがないことを保証するものではありません。万が一、本資料に記載された情報の誤りによりお客様又は第三者に損害が生じた場合においても、ロームは一切その責任を負いません。